

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年11月13日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-347606

出 願 人

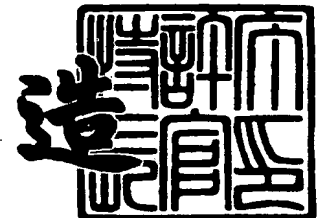
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年11月30日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3105685

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0085697

【提出日】 平成13年11月13日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/1343

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 露木 正

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 松尾 睦

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 田中 千浩

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】 100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-392828

【出願日】 平成12年12月25日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶装置用基板、液晶装置用基板の製造方法、液晶装置、液晶装置の製造方法及び電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板において、基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、該光反射膜は光指向性及び光散乱性を呈するパターンを有することを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記パターンは複数の山部及び／又は複数の谷部を並べて形成されることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 3】 請求項 2 において、前記山部及び／又は前記谷部は、自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 4】 請求項 2 において、前記山部及び／又は前記谷部は、自らを通る直交 2 軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の立体形状と他方の側の立体形状とが互いに非対称であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 5】 請求項 4 において、前記立体形状の面積が前記一方の側と前記他方の側とで非対称であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 6】 請求項 4 において、前記立体形状の前記基材に対する角度が前記一方の側と前記他方の側とで非対称であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 7】 請求項 2 において、前記山部及び／又は前記谷部は液滴形状であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 8】 請求項 2 において、前記山部及び／又は前記谷部は、平面断面が長方形のピラミッド形状、平面断面が長方形のドーム形状、平面断面が楕円のドーム形状又は平面断面が長円のドーム形状であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 9】 請求項 2 から請求項 8 の少なくともいずれか 1 つにおいて、

前記複数の山部及び／又は前記複数の谷部は互いに同じ方向で且つ平面内で無秩序に並べられることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 1 0】 請求項 1 から請求項 8 の少なくともいずれか 1 つにおいて、前記直交 2 軸線の少なくとも一方は前記基材の端辺に平行であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 1 1】 液晶を挟持する一对の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板において、

基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、

該光反射膜の表面には複数の山部及び／又は複数の谷部を並べて成る光反射パターンが形成され、

該光反射パターンで反射する光の光量に関して、前記山部及び／又は前記谷部を通る直交 2 軸線の一方に沿った光量プロファイルと、直交 2 軸線の他方に沿った光量プロファイルとが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 1 2】 請求項 2 0 において、前記一方の軸線に沿った光量プロファイルは山形状であり、前記他方の軸線に沿った光量プロファイルは直線状であることを特徴とする液晶装置用基板。

【請求項 1 3】 液晶を挟持する一对の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、

基材の表面に光反射膜を形成する工程と、

マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部及び／又は複数の谷部を形成する工程とを有し、

前記複数の山部及び／又は前記複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った形状と、他方の軸線に沿った形状とが互いに異なることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項 1 4】 液晶を挟持する一对の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、

基材の表面に光反射膜を形成する工程と、

マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部及び／又は複数の谷部を形成する工程とを有し、

前記複数の山部及び／又は前記複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の形状と他方の側の形状とが互いに非対称であることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項 1 5】 請求項 1 3 又は請求項 1 4 において、前記複数の山部及び／又は前記複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは平面的な液滴形状であることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項 1 6】 請求項 1 3 又は請求項 1 4 において、前記複数の山部及び／又は前記複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは互いに同じ方向で且つ平面内で無秩序に並べられることを特徴とする液晶装置用基板の製造方法。

【請求項 1 7】 液晶を挟持する一対の基板を有する液晶装置において、該一対の基板の一方は請求項 1 から請求項 1 2 のいずれかに記載した液晶装置用基板によって構成されることを特徴とする液晶装置。

【請求項 1 8】 液晶を挟持する一対の基板を有する液晶装置の製造方法において、請求項 1 3 から請求項 1 6 のいずれかに記載した液晶装置用基板の製造方法を用いて前記一対の基板の一方を形成する工程を有することを特徴とする液晶装置の製造方法。

【請求項 1 9】 像を表示する液晶装置と、該液晶装置を収容する筐体と、前記液晶装置を制御する制御回路とを有する電子機器において、前記液晶装置は請求項 1 7 に記載した液晶装置によって構成されることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶装置の構成要素である液晶装置用基板及びその製造方法に関する。また、本発明は、液晶装置用基板を用いて構成される液晶装置及びその製造方法に関する。また、本発明は、液晶装置を用いて構成される電子機器に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、携帯電話機、携帯型パーソナルコンピュータ等といった電子機器に液晶装置が広く用いられるようになってきている。この液晶装置の1つとして、反射型表示が可能な液晶装置が知られている。この液晶装置では、自然光や室内光等といった外部光が該液晶装置の内部へ取り込まれ、この光が該液晶装置の内部に設けた光反射膜で反射して再び外部へ出射することにより表示が行われる。

【0003】

この構成によれば、バックライトすなわち照明装置を用いなくても表示が出来るので、消費電力を低く抑えることができる。また、バックライトを付設しない場合には薄型化及び軽量化を達成できる。

【0004】

この反射型表示が可能な液晶装置においては、光反射膜の表面が鏡面状であると、観察者が視認する像に背景や室内照明が映ってしまい、表示された像が見難くなるという問題が生じる。この問題を解消するため、従来、上記光反射膜の表面に複数の微細な山部を形成して粗面化して、反射光を適度に散乱させるという技術が知られている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上記従来の液晶装置用基板における光反射面の粗面化によってもたらされる反射光は、光量が上下左右の全領域で均一になるように設定されていた。例えば、図17に示すように、液晶装置用基板91に法線方向から光R0を照射すると共に、ディテクタ例えばフォトマルチメータ92を直交2軸線であるX軸線及びY軸線の各方向へ移動させながら、反射光R1の光量を測定したところ、図18に示すように、X軸線方向における $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の範囲の反射光量プロファイル Q_X と、Y軸線方向における $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ の範囲の反射光量プロファイル Q_Y とは同じプロファイルとなっていた。

【0006】

上記のような方向性の無い反射光は、液晶装置において均一な明るさの像を表示させるという観点から見れば有効であるが、液晶装置の表示面を常に特定の1

つの方向から観察するような場合には、不要な視野角方向に光が供給される分だけ、光が無駄に費やされていたと考えられる。

【0007】

本発明は、上記の問題点に鑑みて成されたものであって、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることにより、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

まず、本発明を原理的に説明する。今、図14(a)及び図14(b)に示すように基材81の表面に光反射膜82を形成し、その光反射膜82の表面に正四角錐形状すなわち正ピラミッド形状の複数の山部10をドットマトリクス状に配列した構造の基板80を考える。この場合、山部10は図15(a)に示すように、平面断面Tが正形状で直交2軸線であるX軸線及びY軸線の両方に関して対称な形状であるとする。また、図15(a)において山部10の4つの側面を“A”、“B”、“C”及び“D”と呼び、また山部10が載っている基材表面を“E”と呼ぶことにする。

【0009】

図14(b)に矢印Aで示すように、複数の山部10を形成した光反射膜82に対して光を照射したとき、図15(a)のY軸線方向に関する反射光量の分布を測定すると、図16に示すように、面積の広い平面Eに対応して光量の大きい反射光eが発生し、側面A及び側面Bに対応して適宜の角度、例えば $\pm 30^\circ$ の所にそれらの面積に対応した光量の反射光a及びcが発生する。この光量分布はX軸線方向に関しても全く同じであり、この結果、図14(a)の基板80に光を照射すると、立体空間の全方位に方向性の無い均一な反射光が得られる。

【0010】

次に、図15(a)における山部10の側面AをY軸線方向の外側へ伸ばした形状の図15(b)に示すような山部10eを考える。すると、この山部10eに関しては側面A'の基材25に対する傾斜角度 θ_2 は側面Cの傾斜角度 θ_1 よ

りも小さくなり、さらに側面A'の面積は山部10における側面Aの面積よりも大きくなる。従って、この山部10eに光が照射されると、図16において、 30° よりも小さい視野角度、例えば 15° の視野角度の所に側面Aの場合よりも光量が少し大きい反射光a'が現れ、さらに、平面Eは面積が狭くなるので反射光e'はそれに対応して反射光の光量が少し小さくなる。

【0011】

つまり、山部10の形状をY軸線方向に変形させてX軸線に関して非対称の形にすると、Y軸線方向に関して特定の不要な視野角方向の反射光量を低減すると同時に、特定の希望する視野角方向の反射光量を意図的に増大させることができる。この結果、例えば本基板80を液晶装置の反射板として用いる場合を考えれば、観察者による視認方向以外の視野角方向の明るさを抑えた上で、観察者が見る視野角方向の明るさだけを意図的に強めることができる。

(1) 本発明は上記のような原理に基づいて成されたものであって、本発明に係る液晶装置用基板は、液晶を挟持する一対の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板において、基材と、該基材の表面に形成された光反射膜とを有し、該光反射膜は光指向性及び光散乱性を呈するパターンを有することを特徴とする。

【0012】

今、一般的な光の反射を考えると、図19に示すように反射面Hに角度 θ_0 で入射した光R0は、等しい角度 θ_0 で反射する。この場合には、反射面Hは、光指向性を呈することも無く、光散乱性を呈することも無い。上記構成における「光指向性」とは、図19において、反射光の主たる成分R1が入射角度 θ_0 とは異なる角度 θ_1 で反射するという特性である。また、「光散乱性」とは、角度 θ_2 から角度 θ_3 の範囲で散乱光が発生するという特性である。

【0013】

主反射光の角度 θ_1 は、散乱角度である θ_2 から θ_3 の範囲内に入る場合もあるし、入らない場合もある。しかしながら、多くの場合、主反射角度 θ_1 は散乱角度範囲である θ_2 から θ_3 の内部に入るように設定され、さらに、望ましくは主反射角度 θ_1 は散乱角度 θ_2 から θ_3 の中心になるように設定される。液晶装

置の場合には、 $\theta 2$ から $\theta 3$ の角度差を約 30° に設定し、全反射光量の60%以上がこの角度範囲内に存在するように設定することが望ましい。

【0014】

上記構成の液晶装置用基板によれば、反射光R1の反射角度 $\theta 1$ が入射角度 $\theta 0$ 以外の角度値に設定されるので、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、これにより、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

【0015】

上記構成の液晶装置において、前記パターンは複数の山部及び／又は複数の谷部を並べて形成できる。また、それらの山部及び／又は谷部は、自らを通る直交2軸線の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なるように形成できる。

【0016】

例えば、光反射膜の表面に多数のドットパターンとして形成する山部は、図11(a)に示すように平面断面が長形状で例えばX軸線方向に長いドーム型の山部10aや、図11(b)に示すように平面断面が長形状で例えばX軸線方向に長い四角錐形状すなわちピラミッド形状の山部10bや、図12(c)に示すように平面断面が長円形状で例えばX軸線方向に長いドーム型の山部10c等のように形成できる。

【0017】

また、山部は、図12(d)に示すように平面形状が液滴形状の山部10dのように形成できる。ここで、液滴形状というのは、尖った一端E0と緩やかに曲がる他端E1とを略直線で結んだ平面形状を有し、且つ尖った先端E0から緩やかに曲がる他端E1にかけて徐々に寸法D、この場合には山の高さD、が大きくなる断面形状を有する形状である。

【0018】

また、光反射膜の表面に多数のドットパターンとして形成する谷部は、図20(a)に示すように平面断面が長形状で例えばX軸線方向に長いドーム型の谷部20aや、図20(b)に示すように平面断面が長形状で例えばX軸線方向

に長い四角錐形状すなわちピラミッド形状の谷部 2 0 b や、図 2 1 (c) に示すように平面断面が長円形状で例えば X 軸線方向に長いドーム型の谷部 2 0 c 等のように形成できる。

【 0 0 1 9 】

また、谷部は、図 2 1 (d) に示すように平面形状が液滴形状の谷部 2 0 d のように形成できる。ここで、液滴形状というのは、尖った一端 E 0 と緩やかに曲がる他端 E 1 とを略直線で結んだ平面形状を有し、且つ尖った先端 E 0 から緩やかに曲がる他端 E 1 にかけて徐々に寸法 D、この場合は谷の深さ D、が大きくなる断面形状を有する形状である。

【 0 0 2 0 】

上記構成の液晶装置用基板によれば、光反射膜は入射した光を立体空間の全方向へ均一に反射するのではなく、特定の視野方向の光量又は強度が強くなるように反射する。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

【 0 0 2 1 】

次に、上記構成の液晶装置用基板において、前記山部及び／又は前記谷部は、自らを通る直交 2 軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の立体形状と他方の側の立体形状とが互いに非対称となるように形成できる。

例えば、光反射膜の山部は、図 1 5 (b) に示すように、1つの側面 A' が対向する側面 C よりも面積が広く且つ基材 2 5 に対する傾斜角度が側面 C よりも小さい大きさの角錐形状すなわちピラミッド形状 1 0 e とすることができる。この形状では、X 軸線によって区分される左部の立体形状と右部の立体形状とが互いに非対称になっている。

【 0 0 2 2 】

また、光反射膜の山部は、図 1 2 (d) に示すように、一方の軸線である Y 軸線によって区分される上部の立体形状と下部の立体形状とが互いに非対称となるように形成することもできる。

【 0 0 2 3 】

また、光反射膜の谷部は、図 2 2 に示すように、1 つの側面 A' が対向する側面 C よりも面積が広く且つ基材 2 5 に対する傾斜角度が側面 C よりも小さい大きさの角錐形状すなわちピラミッド形状 2 0 e とすることができる。この形状では、X 軸線によって区分される左部の立体形状と右部の立体形状とが互いに非対称になっている。また、光反射膜の谷部は、図 2 1 (d) に示すように、一方の軸線である Y 軸線によって区分される上部の立体形状と下部の立体形状とが互いに非対称となるように形成することもできる。

【 0 0 2 4 】

上記構成の液晶装置用基板によれば、光反射膜は入射した光を立体空間の全方向へ均一に反射するのではなく、特定の方向の光量又は強度が強くなるように反射する。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

【 0 0 2 5 】

上記構成の液晶装置用基板において、軸線によって区分される部分の立体形状を該軸線に関して非対称にするという構成要件は、例えば、面積に関して非対称にしたり、基材に対する角度に関して非対称にしたりする等といった具体例が考えられる。面積に関して非対称にすることは、例えば図 1 5 (b) の山部 1 0 e のように X 軸線の左側面 C の面積と右側面 A' の面積とを異ならせることや、例えば図 2 2 の谷部 2 0 e のように X 軸線の左側面 C の面積と右側面 A' の面積とを異ならせることによって実現できる。

【 0 0 2 6 】

また、角度に関して非対称にすることは、例えば図 1 5 (b) の山部 1 0 e のように X 軸線の左側面 C の基材 2 5 に対する角度 $\theta 1$ と右側面 A' の基板 2 5 に対する角度 $\theta 2$ とを異ならせることや、例えば図 2 2 の谷部 2 0 e のように X 軸線の左側面 C の基材 2 5 に対する角度 $\theta 1$ と右側面 A' の基板 2 5 に対する角度 $\theta 2$ とを異ならせることによって実現できる。

【 0 0 2 7 】

次に、上記構成の液晶装置用基板においては、山部及び／又は谷部の形状を特

たような特性を有する光反射パターンにより、上記構成の液晶装置用基板を実現できる。

【 0 0 3 2 】

図 1 3 に示す特性を有する液晶装置用基板を用いれば、Y 方向に沿って目を移動させたときには、中央部が明るく両端部が暗い表示が視認できる。一方、X 方向に沿って目を移動させたときには、一方の端部から他方の端部にわたって均一な明るさの表示を見ることができる。X 方向に沿った見え方と Y 方向に沿った見え方とを比べれば、X 方向に沿った見え方は両端部側、すなわち低角度側から表示面を見たときの明るさが増大する。

(2) 次に、本発明に係る液晶装置用基板の製造方法は、液晶を挟持する一对の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、基材の表面に光反射膜を形成する工程と、マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部及び／又は複数の谷部を形成する工程とを有し、前記複数の山部及び／又は複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線の一方の軸線に沿った形状と、他方の軸線に沿った形状とが互いに異なることを特徴とする。この構成の液晶装置用基板の製造方法によれば、上記の液晶装置用基板を確実に製造することができる。

【 0 0 3 3 】

次に、本発明に係る液晶装置用基板の製造方法は、液晶を挟持する一对の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板の製造方法において、基材の表面に光反射膜を形成する工程と、マスクを用いて前記光反射膜の表面に複数の山部及び／又は複数の谷部を形成する工程とを有し、前記複数の山部及び／又は複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは、自らを通る直交 2 軸線のうちの少なくとも一方の軸線によって区分される一方の側の形状と他方の側の形状とが互いに非対称であることを特徴とする。この構成の液晶装置用基板の製造方法によれば、上記の液晶装置用基板を確実に製造することができる。

【 0 0 3 4 】

上記構成の液晶装置用基板の製造方法において、前記複数の山部及び／又は複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは平面的な液滴形状とすること

ができる。ここで、平面的な液滴形状とは、尖った一端と緩やかに曲がる他端とを略直線で結んだ平面形状である。また、上記構成の液晶装置用基板の製造方法において、前記複数の山部及び／又は複数の谷部に対応する前記マスクのマスクパターンは互いに同じ方向で且つ平面内で無秩序に並べることができる。

(3) 次に、本発明に係る液晶装置は、液晶を挟持する一对の基板を有する液晶装置において、該一对の基板の一方は、以上に説明した各種構成の液晶装置用基板によって構成されることを特徴とする。

【0035】

この構成の液晶装置によれば、内部の反射膜で反射して液晶層に供給される光の反射角度を当該光の液晶装置への入射角度以外の角度値に設定できるので、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、これにより、液晶装置の表示面を希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

(4) 次に、本発明に係る液晶装置の製造方法は、液晶を挟持する一对の基板を有する液晶装置の製造方法において、以上に説明した液晶装置用基板の製造方法を用いて前記一对の基板の一方を形成する工程を有することを特徴とする。

(5) 次に、本発明に係る電子機器は、像を表示する液晶装置と、該液晶装置を収容する筐体と、前記液晶装置を制御する制御回路とを有する電子機器において、前記液晶装置は、以上に記載した構成の液晶装置によって構成されることを特徴とする。この電子機器によれば、液晶装置の表示を見る者にとって、好ましい視野角方向に鮮明な像を形成することができる。

【0036】

【発明の実施の形態】

以下、本発明を実施形態に基づいて、より具体的に説明する。

【0037】

(液晶装置用基板及び液晶装置の第1実施形態)

図1及び図2は、本発明に係る液晶装置用基板を用いた本発明に係る液晶装置の一実施形態の主要部、特に1つの表示ドット部分を拡大して示している。この液晶装置の全体構造は例えば図3に示すように設定できる。なお、例えば、R (

赤)、G(緑)、B(青)の3原色によってフルカラー表示を行う場合を考えれば、上記の1つの表示ドットはそれら3色の個々に対応するドットであり、これらの表示ドットが3個集まることによって1つの画素が形成される。また、白黒表示を行う場合を考えれば、上記の1つの表示ドットがそのまま1つの画素に相当する。

【0038】

本実施形態に係る液晶装置は、アクティブ素子として3端子型の能動素子であるTFT(Thin Film Transistor)を用いたアクティブマトリクス方式の液晶装置であり、自然光等といった外部光を用いて表示を行う方式の反射型液晶装置であり、そして液晶駆動用ICを基板上に直接に実装する方式のCOG(Chip On Glass)方式の液晶装置である。

【0039】

図3において、液晶装置1は第1基板2aと第2基板2bとをそれらの周辺部において環状のシール材3によって貼り合わせ、さらに、第1基板2a、第2基板2b及びシール材3によって囲まれる間隙すなわちセルギャップ内に液晶を封入することによって形成される。また、本実施形態では、一方の基板2aの表面に液晶駆動用IC4a及び4bが直接に実装されている。

【0040】

第1基板2aのシール材3によって囲まれる内部領域には、複数の画素電極が行方向XX及び列方向YYに関してドットマトリクス状の配列で形成される。また、第2基板2bのシール材3によって囲まれる内部領域には、無パターンの面状電極が形成され、その面状電極が第1基板2a側の複数の画素電極に対向して配置される。

【0041】

第1基板2a上の1つの画素電極と第2基板2b上の面状電極によって液晶を挟んだ部分が1つの表示ドットを形成し、この表示ドットの複数個がシール材3によって囲まれる内部領域内でドットマトリクス状に配列することによって表示領域Vが形成される。液晶駆動用IC4a及び4bは複数の表示ドットを形成している対向電極間に選択的に走査信号及びデータ信号を印加することにより、液

が維持され、そのセルギャップ内に液晶Lが封入される。

【 0 0 4 7 】

TFT 7は、基材6 a上に形成されたゲート電極1 6と、このゲート電極1 6の上で基材6 aの全域に形成されたゲート絶縁膜1 7と、このゲート絶縁膜1 7を挟んでゲート電極1 6の上方位置に形成された半導体層1 8と、その半導体層1 8の一方の側にコンタクト電極1 9を介して形成されたソース電極2 1と、さらに半導体層1 8の他方の側にコンタクト電極1 9を介して形成されたドレイン電極2 2とを有する。

【 0 0 4 8 】

図2に示すように、ゲート電極1 6はゲートバス配線2 3から延びている。また、ソース電極2 1はソースバス配線2 4から延びている。ゲートバス配線2 3は基材6 aの横方向に延びていて縦方向へ等間隔で平行に複数本形成される。また、ソースバス配線2 4はゲート絶縁膜1 7（図1参照）を挟んでゲートバス配線2 3と交差するように縦方向へ延びていて横方向へ等間隔で平行に複数本形成される。

【 0 0 4 9 】

ゲートバス配線2 3は図3の液晶駆動用IC 4 a及び4 bの一方に接続されて例えば走査線として作用し、他方、ソースバス配線2 4は液晶駆動用IC 4 a及び4 bの他方に接続されて例えば信号線として作用する。また、画素電極9は、図2に示すように、互いに交差するゲートバス配線2 3とソースバス配線2 4とによって区画される方形領域のうちTFT 7に対応する部分を除いた領域を覆うように形成される。

【 0 0 5 0 】

ゲートバス配線2 3及びゲート電極1 6は、例えばクロム、タンタル等によって形成される。ゲート絶縁膜1 7は、例えば窒化シリコン(SiN_X)、酸化シリコン(SiO_X)等によって形成される。半導体層1 8は、例えばa-Si、多結晶シリコン、CdSe等によって形成される。コンタクト電極1 9は、例えばa-Si等によって形成される。ソース電極2 1及びそれと一体なソースバス配線2 4並びにドレイン電極2 2は、例えばチタン、モリブデン、アルミニウム

等によって形成される。

【 0 0 5 1 】

図 1 に示す有機絶縁膜 8 は、ゲートバス配線 2 3、ソースバス配線 2 4 及び T F T 7 を覆って基材 6 a 上の全域に形成されている。但し、有機絶縁膜 8 のドレイン電極 2 2 に対応する部分にはコンタクトホール 2 6 が形成され、このコンタクトホール 2 6 の所で画素電極 9 と T F T 7 のドレイン電極 2 2 との導通がなされている。有機絶縁膜 8 のうち画素電極 9 が形成される領域には、例えば、図 1 2 (c) に示すような長円形状でドーム形状の山部 1 0 c が互いに微小間隔で規則的に、本実施形態では規則的なマトリクス状の配列となるように形成されている。この結果、有機絶縁膜 8 の上に積層される画素電極 9 も同様にして複数の山部 1 0 c の配列から成る光反射パターンを有することになる。

【 0 0 5 2 】

上記の山部 1 0 c は、図 2 において、ソースバス配線 2 4 の延在方向である X 軸線方向を長軸とし、それと直角な Y 軸線方向を短軸となるように配列されている。また、山部 1 0 c の長軸方向 X は図 3 において基材 6 a の X X 方向に延びる端辺に対して平行に設定され、短軸方向 Y は基材 6 a の Y Y 方向に延びる端辺に対して平行に設定されている。このように、山部 1 0 c を規定する X、Y 軸線方向と液晶装置 1 の基板 6 a 等の端辺方向 X X、Y Y との間に関連付けをしておけば、どの視野角度方向から液晶装置 1 の表示領域 V を見たときに明るい表示を見ることができるかを、容易に判断できる。

【 0 0 5 3 】

本実施形態では、画素電極 9 を、例えば A l (アルミニウム)、A g (銀) 等といった光反射性の導電材料によって形成することにより、当該画素電極 9 を光反射膜として機能させている。また、その画素電極 9 の表面に複数の山部 1 0 c から成る反射パターンを設けたので、画素電極 9 は図 1 9 に示すような、光指向性及び光散乱性の両方を呈する反射パターンとして機能する。

【 0 0 5 4 】

本実施形態の液晶装置 1 は以上のように構成されているので、図 1 において、観察者側すなわち第 2 基板 2 b 側から液晶装置 1 の内部へ入った外部光は、液晶

Lを通過して光反射性材料によって形成された画素電極9に到達し、該電極9で反射して再び液晶Lへ供給される。液晶Lは、走査信号及びデータ信号によって選択される画素電極9と対向電極13との間に印加される電圧によって表示ドット毎にその配向が制御され、これにより、液晶Lに供給された反射光は表示ドット毎に変調され、これにより観察者側に文字、数字等といった像が表示される。

本実施形態では、光反射膜として作用する画素電極9の表面に複数の山部10cを規則的に配列して成る反射パターンが形成されると共に、それら複数の山部10cはX軸線に沿った立体形状とY軸線に沿った立体形状とが互いに異なっているため、一定の視野角方向への反射光量を低く抑えた上で、別の特定の視野角方向への反射光量を増大させることができる。この結果、観察者は、液晶装置1の表示領域V内に表示される像を特定の視野角方向から非常に明るい表示として観察できる。

【0055】

（液晶装置の製造方法の第1実施形態）

図4は、図1等にした液晶装置1の製造方法を工程順に示している。この工程図に基づいて液晶装置1の製造方法を説明すれば、まず、工程P1において第1基板2a（図1参照）を作製し、工程P2において第2基板2bを作製する。通常の製造工程では、図3に示す液晶装置1の1個分の第1基板2a及び第2基板2bを1個ずつ作製するのではなく、1つの大面積の基材、いわゆるマザーボードの表面に液晶装置の複数個分の第1基板2aを形成し、他の1つのマザーボードの表面に液晶装置の複数個分の第2基板2bを形成する。

【0056】

その後、複数の第1基板パターンが形成された第1基板マザーボードと、複数の第2基板パターンが形成された第2基板マザーボードとを互いに位置合わせ、すなわちアライメントした状態でシール材3によって貼り合わせて、大面積の空のパネル構造を形成する（工程P3）。次に、各液晶装置1内のシール材3の一部に形成された液晶注入口3a（図3参照）が外部に露出するように、上記大面積のパネル構造をブレイクすなわち切断して、いわゆる短冊状のパネル構造を形成する（工程P4）。

【 0 0 5 7 】

次に、作製された短冊状のパネル構造の液晶注入口 3 a からパネル構造の内部に液晶を注入し、さらに注入完了後の液晶注入口 3 a を樹脂によって封止する（工程 P 5）。その後、液晶封入後の短冊状のパネル構造を図 3 に示すような 1 個の液晶装置 1 の大きさにブレイクすなわち切断し（工程 P 6）、さらに液晶駆動用 IC 4 a 及び 4 b を一方の基板の表面に実装する（工程 P 7）。さらに、第 1 基板 2 a 及び第 2 基板 2 b の外側表面に偏光板を貼着し、さらに必要に応じてその他の光学要素、例えば位相差板等を取り付け、これにより、図 3 の液晶装置 1 が完成する。

【 0 0 5 8 】

上記のような液晶装置の製造方法において、特に、第 1 基板形成工程 P 1 は例えば図 5 に示す製造方法によって実現される。具体的には、工程 P 1 1 及び図 6 (a) において、ガラス等から成る基材 6 a の上に、例えばスパッタリング法によってタンタル金属膜を形成し、この金属膜を例えばフォトリソグラフィー法によってパターニングして、ゲートバス配線 2 3 及びそれと一体なゲート電極 1 6 を形成する。

【 0 0 5 9 】

次に、工程 P 1 2 及び図 6 (a) において、例えばプラズマ CVD 法によって窒化シリコンから成るゲート絶縁膜 1 7 を形成する。次に、工程 P 1 3 及び図 6 (a) において、半導体層 1 8 となる a-Si 層と、コンタクト電極 1 9 となる n^+ 型 a-Si 層とをこの順で連続的に形成し、さらに、形成された n^+ 型 a-Si 層及び a-Si 層のパターニングを行って半導体層 1 8 及びコンタクト電極 1 9 とを形成する。

【 0 0 6 0 】

次に、工程 P 1 4 及び図 6 (a) において、基材 6 a の表面の全域に例えばモリブデン金属をスパッタ法によって形成し、このモリブデン金属層のパターニングを行って、ソース電極 2 1、ドレイン電極 2 2 及びソースバス配線 2 4 を形成し、これにより TFT 7 が完成する。次に、工程 P 1 5 及び図 6 (b) において、TFT 7 を形成した基材 6 a 上の全面に例えばポリイミド樹脂をスピコート

して有機絶縁膜 8 を形成する。

【0061】

次に、工程 16 及び図 6 (b) において、フォトリソグラフィ法を用いて有機絶縁膜 8 にコンタクトホール 26 を形成する。次に、工程 P17 及び図 6 (c) において、有機絶縁膜 8 の上にフォトレジスト 27 を塗布し、図 7 に示すようなマスク 28 を用いて画素電極 9 の形成領域のフォトレジスト 27 をパターンニングする。このときに用いるマスク 28 には、X 軸線方向に長軸を有し、それと直角な Y 軸線方向に短軸を有する長円形状のマスクパターン 29 が形成される。

【0062】

次に、工程 18 及び図 6 (d) において、フォトレジスト 27 の無い部分の有機絶縁膜 8 をエッチングによって除去して規則的に並ぶ山部 10c を形成する。このとき、コンタクトホール 26 及び TFT7 の上の有機絶縁膜 8 はフォトレジスト 27 によって保護されてエッチングによって除去されない。エッチング処理後、フォトレジスト 27 は薬品や光照射によって除去される。

【0063】

その後、工程 P19 及び図 6 (e) において、有機絶縁膜 8 の上の全域にアルミニウム層を形成し、さらにパターンニングして光反射膜を兼ねる画素電極 38 を形成する。このとき、画素電極 38 の下地となる有機絶縁膜 8 の表面に山部 10c のパターンが形成されているので、画素電極 38 も同様の山部 10c を有するパターン、すなわち光反射パターンを有することになる。画素電極 38 は有機絶縁膜 26 に形成されたコンタクトホール 26 を介して TFT7 のドレイン電極 2 に接続される。

【0064】

その後、工程 P20 において基材 8 の表面の全域にポリイミド樹脂を塗布及び焼成することによって配向膜 11a (図 1 参照) を形成し、それにラビング処理を施し、さらに工程 P21 においてスクリーン印刷等を用いてシール材 3 (図 3 参照) を形成し、さらに工程 P22 においてスペーサ 14 (図 1 参照) を分散し、これにより第 1 基板 2a が完成する。

【0065】

なお、以上の実施形態では図 7 のマスクパターン 2 9 として図 1 2 (c) に示す断面長円形ドーム形状の山部 1 0 c を形成できるパターンを用いたが、これに代えて、図 1 1 (a) に示す断面長方形ドーム形状や、図 1 1 (b) に示す断面長方形ピラミッド形状や、図 1 2 (d) に示す液滴ドーム形状や、図 1 5 (b) に示す断面長方形で偏形のピラミッド形状や、図 1 3 に示すように直交 2 軸線方向で光量分布が異なるような形状を採用することができる。

【 0 0 6 6 】

(液晶装置用基板及び液晶装置の第 2 実施形態)

図 8 は、本発明に係る液晶装置用基板を用いた本発明に係る液晶装置の他の実施形態の主要部、特に数個の表示ドット部分を拡大して示している。この液晶装置の全体構造は例えば図 3 に示すように設定できる。

【 0 0 6 7 】

本実施形態に係る液晶装置は、アクティブ素子として 2 端子型の能動素子である T F D (Thin Film Diode) を用いたアクティブマトリクス方式の液晶装置であり、自然光等といった外部光を用いた反射表示と照明装置を用いた透過表示を選択的に行うことができる方式の半透過反射型液晶装置であり、そして液晶駆動用 I C を基板上に直接に実装する方式の C O G (Chip On Glass) 方式の液晶装置である。

【 0 0 6 8 】

本実施形態においても液晶装置 1 は、図 3 において、第 1 基板 2 a と第 2 基板 2 b とをシール材 3 によって貼り合わせ、さらに、第 1 基板 2 a 、第 2 基板 2 b 及びシール材 3 によって囲まれる間隙すなわちセルギャップ内に液晶を封入することによって形成される。また、一方の基板 2 a の表面に液晶駆動用 I C 4 a 及び 4 b が直接に実装されている。

【 0 0 6 9 】

第 2 基板 2 b のシール材 3 によって囲まれる内部領域には、複数の画素電極が行方向 X X 及び列方向 Y Y に関してドットマトリクス状の配列で形成される。また、第 1 基板 2 a のシール材 3 によって囲まれる内部領域にはストライプ状の電極が形成され、そのストライプ状電極が第 2 基板 2 b 側の複数の画素電極に対向

して配置される。

【 0 0 7 0 】

第 1 基板 2 a 上のストライプ状電極と第 2 基板 2 b 上の 1 つの画素電極によって液晶を挟んだ部分が 1 つの表示ドットを形成し、この表示ドットの複数個がシール材 3 によって囲まれる内部領域内でドットマトリクス状に配列することによって表示領域 V が形成される。液晶駆動用 I C 4 a 及び 4 b は複数の表示ドット内の対向電極間に選択的に走査信号及びデータ信号を印加することにより、液晶の配向を表示ドット毎に制御する。この液晶の配向制御により該液晶を通過する光が変調されて、表示領域 V 内に文字、数字等といった像が表示される。

【 0 0 7 1 】

図 8 は、液晶装置 1 において表示領域 V を構成する複数の表示ドットのうちの数個の断面構造を拡大して示している。また、図 9 は、1 つの表示ドット部分の断面構造を示している。

【 0 0 7 2 】

図 8 において、第 1 基板 2 a は、ガラス、プラスチック等によって形成された基材 6 a と、その基材 6 a の内側表面に形成された光反射膜 3 1 と、その光反射膜 3 1 の上に形成されたカラーフィルタ 1 2 と、そのカラーフィルタ 1 2 の上に形成された透明なストライプ状電極 1 3 とを有する。そのストライプ状電極 1 3 の上には図 9 に示すように配向膜 1 1 a が形成される。この配向膜 1 1 a に対して配向処理としてのラビング処理が施される。ストライプ状電極 1 3 は、例えば I T O (Indium Tin Oxide) 等といった透明な導電材料によって形成される。

【 0 0 7 3 】

第 1 基板 2 a に対向する第 2 基板 2 b は、ガラス、プラスチック等によって形成された基材 6 b と、その基材 6 b の内側表面に形成されたスイッチング素子として機能するアクティブ素子としての T F D (Thin Film Diode) 3 7 と、T F D 3 7 に接続された画素電極 9 とを有する。T F D 3 7 及び画素電極 9 の上には図 9 に示すように配向膜 1 1 b が形成され、この配向膜 1 1 b に対して配向処理としてのラビング処理が施される。画素電極 9 は、例えば I T O (Indium Tin Oxide) 等といった透明な導電材料によって形成される。

【0074】

第1基板2aに属するカラーフィルタ12は、第2基板2b側の画素電極9に対向する位置にR（赤）、G（緑）、B（青）又はC（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）等といった各色のいずれかの色フィルタエレメント12aを有し、画素電極9に対向しない位置にブラックマスク12bを有する。

【0075】

図9において、第1基板2aと第2基板2bとの間の間隔、すなわちセルギャップはいずれか一方の基板の表面に分散された球状のスペーサ14によって寸法が維持され、そのセルギャップ内に液晶Lが封入される。

【0076】

TFD37は、図9及び図10に示すように、第1金属層34と、その第1金属層34の表面に形成された絶縁層36と、その絶縁層36の上に形成された第2金属層38とによって構成されている。このようにTFD37は、第1金属層／絶縁層／第2金属層から成る積層構造、いわゆるMIM（Metal Insulator Metal）構造によって構成されている。

【0077】

第1金属層34は、例えば、タンタル単体、タンタル合金等によって形成される。第1金属層34としてタンタル合金を用いる場合には、主成分のタンタルに、例えば、タングステン、クロム、モリブデン、レニウム、イットリウム、ランタン、ディスプロリウム等といった周期律表において第6～第8族に属する元素が添加される。

【0078】

第1金属層34はライン配線39の第1層39aと一体に形成される。このライン配線39は画素電極9を間に挟んでストライプ状に形成され、画素電極9へ走査信号を供給するための走査線又は画素電極9へデータ信号を供給するためのデータ線として作用する。

【0079】

絶縁層36は、例えば、陽極酸化法によって第1金属層34の表面を酸化することによって形成された酸化タンタル（ Ta_2O_3 ）によって構成される。なお

、第1金属層34を陽極酸化したときには、ライン配線39の第1層39aの表面も同時に酸化されて、同様に酸化タンタルから成る第2層39bが形成される。

【0080】

第2金属層38は、例えばCr等といった導電材によって形成される。画素電極9は、その一部が第2金属層38の先端に重なるように基材6bの表面に形成される。なお、基材6bの表面には、第1金属層34及びライン配線の第1層39aを形成する前に酸化タンタル等によって下地層を形成することがある。これは、第2金属層38の体積後における熱処理によって第1金属層34が下地から剥離しないようにしたり、第1金属層34に不純物が拡散しないようにしたりするためである。

【0081】

図8において、基材6aの外側表面には位相差板32aが貼着等によって装着され、さらにその位相差板32aの上に偏光板33aが貼着等によって装着される。また、基材6bの外側表面には位相差板32bが貼着等によって装着され、さらにその位相差板32bの上に偏光板33bが貼着等によって装着される。

【0082】

例えばSTN (Super Twisted Nematic) 液晶等を用いると、該液晶を通過する光に波長分散が発生して表示像に着色が発生することがある。位相差板32a及び32bはそのような着色を除去するために用いられる光学的異方体であり、例えばポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリエーテルアミド、ポリエチレン等といった樹脂を一軸延伸処理することによって形成されるフィルムによって構成できる。

【0083】

偏光板33a及び33bは、自然光の入射に対してある一方向の直線偏光を出射する機能を有するフィルム状光学要素であり、例えば、偏光層をTAC (三酢酸セルロース) の保護層で挟むことによって形成できる。偏光板33a及び33bは、通常は、互いの透過偏光軸を異ならせて配置する。

【0084】

光反射膜 3 1 は、例えば、アルミニウム等といった光反射性の金属によって形成され、第 2 基板 2 b に属する各画素電極 9 に対応する位置、すなわち各表示ドットに対応する位置に光透過用の開口 4 1 が形成される。また、光反射膜 3 1 の液晶側表面には、例えば、図 1 2 (c) に示すような長円形状でドーム形状の山部 1 0 c が互いに微小間隔で規則的に、本実施形態では規則的なマトリクス状の配列となるように形成されている。

【 0 0 8 5 】

上記の山部 1 0 c は、ライン配線 3 9 の延在方向である X 軸線方向を長軸とし、それと直角な Y 軸線方向が短軸となるように配列されている。また、山部 1 0 c の長軸方向 X は図 3 において基材 6 a の X X 方向に延びる端辺に対して平行に設定され、短軸方向 Y は基材 6 a の Y Y 方向に延びる端辺に対して平行に設定されている。

【 0 0 8 6 】

本実施形態の液晶装置 1 は以上のように構成されているので、当該液晶装置 1 が反射型表示を行う場合には、図 8 において、観察者側すなわち第 2 基板 2 b 側から液晶装置 1 の内部へ入った外部光は、液晶 L を通過して光反射膜 3 1 に到達し、該反射膜 3 1 で反射して再び液晶 L へ供給される（図 9 の矢印 F 1 参照）。液晶 L は、画素電極 9 とストライプ状対向電極 1 3 との間に印加される電圧、すなわち走査信号及びデータ信号によって表示ドット毎にその配向が制御され、これにより、液晶 L に供給された反射光は表示ドット毎に変調され、これにより観察者側に文字、数字等といった像が表示される。

【 0 0 8 7 】

他方、液晶装置 1 が透過型表示を行う場合には、第 1 基板 2 a の外側に配置された照明装置、いわゆるバックライト 4 2 が発光し、この発光が偏光板 3 3 a、位相差板 3 2 a、基材 6 a、光反射膜 3 1 の開口 4 1、カラーフィルタ 1 2、電極 1 3 及び配向膜 1 1 a を通過した後に液晶 L に供給される（図 9 の矢印 F 2 参照）。この後、反射型表示の場合と同様にして表示が行われる。

【 0 0 8 8 】

本実施形態では、光反射膜 3 1 の表面に複数の山部 1 0 c を規則的に配列して

成る反射パターンが形成されると共に、それら複数の山部 1 0 c は X 軸線に沿った立体形状と Y 軸線に沿った立体形状とが互いに異なっているので、一定の視野角方向への反射光量を低く抑えた上で、別の特定の視野角方向への反射光量を増大させることができる。この結果、観察者は、光反射膜 3 1 を用いて行われる反射型表示の際に、液晶装置 1 の表示領域 V 内に表示される像を特定の視野角方向に関して非常に明るい表示として観察できる。

【 0 0 8 9 】

本実施形態の液晶装置 1 は、既に説明した図 4 に示す製造方法によって製造することができる。また、第 1 基板 2 a 及び第 2 基板 2 b の形成方法も従来周知の方法を採用できる。なお、図 8 において第 1 基板 2 a の表面に光反射膜 3 1 を形成し、さらにその光反射膜に開口 4 1 及び反射パターンとしての山部 1 0 c を形成する際には、例えば、図 7 に示すような長円形状のマスクパターン 2 9 を縦横のマトリクス状に配列して成るマスク 2 8 を用いて行われるフォトリソグラフィ法を採用することができる。

【 0 0 9 0 】

なお、上記実施形態では図 7 のマスクパターン 2 9 として図 1 2 (c) に示す平面断面が長円形状でドーム形状の山部 1 0 c を形成できるパターンを用いたが、これに代えて、図 1 1 (a) に示すような平面断面が長方形形状でドーム形状の山部 1 0 a や、図 1 1 (b) に示すような平面断面が長方形形状でピラミッド形状の山部 1 0 b や、図 1 2 (d) に示すような液滴ドーム形状の山部 1 0 d や、図 1 5 (b) に示すような平面断面が長方形形状で偏ったピラミッド形状の山部や、図 1 3 に示すように直交 2 軸線方向で光量分布が異なるような山部等を形成できる各種パターンを採用することができる。

【 0 0 9 1 】

なお、図 1 に示す実施形態では、光反射膜として作用する画素電極 9 の表面状態に関して、隣り合う山部 1 0 c 同士の間、図面上、鮮明な平坦部が形成されている。また、図 9 に示す実施形態では、光反射膜 3 1 の表面状態に関して、隣り合う山部 1 0 c 同士の間、図面上、鮮明な平坦部が形成されている。しかしながら、実際の山部形成工程においては、そのような鮮明な平坦部が形成される

ことは稀であり、多くの場合は図 2 5 に示すように、山部 1 0 c 同士の間は平坦でない湾曲形状に形成され则认为られる。本発明のように、光反射膜によって光指向性及び光散乱性を實現しようとする場合、特に光散乱性を達成するためには、山部同士の間が鮮明な平坦面であるよりは、かえって上記のように山部同士の間が湾曲形状になっていた方が好ましいと认为られる。平坦面では鏡面反射が生じるので光散乱の程度が低くなるからである。

【 0 0 9 2 】

(液晶装置用基板及び液晶装置の第 3 実施形態)

図 1 に示した液晶装置 1 では、光反射膜として作用する画素電極 9 に図 1 2 (c) に示した山部 1 0 c のような山部を複数個並べて成るパターンを、光指向性及び光散乱性を呈するパターンとして形成した。また、図 8 に示した液晶装置 1 では、そのような山部を複数個並べて成るパターンを光指向性及び光散乱性を呈するパターンとして光反射膜 3 1 に形成した。

【 0 0 9 3 】

しかしながら、本発明に係る液晶装置用基板、液晶装置、電子機器及びそれらの製造方法においては、光指向性及び光散乱性を呈するパターンとして、複数の山部を並べて成るパターンに代えて、複数の谷部を並べて成るパターンを光指向性及び光散乱性を呈するパターンとして光反射膜に形成することができる。

【 0 0 9 4 】

具体的には、例えば、図 2 0 (a) に示すような平面断面が長形状でドーム形状の谷部 2 0 a や、図 2 0 (b) に示すような平面断面が長形状でピラミッド形状の谷部 2 0 b や、図 2 1 (c) に示すような平面断面が長円形状でドーム形状の谷部 2 0 c や、図 2 1 (d) に示すような液滴形状の谷部 2 0 d や、図 2 2 に示すような平面断面が長形状で Y 軸線方向に偏ったピラミッド形状の谷部 2 0 e や、図 1 3 に示すように直交 2 軸線方向で光量分布が異なるような谷部等といった各種の谷部を複数個並べることによって光指向性及び光散乱性を呈するパターンを形成することができる。

【 0 0 9 5 】

なお、図 2 0、図 2 1 及び図 2 2 において、X 軸線及び Y 軸線は、図 1 1 等に

示した山部 1 0 a 等の場合と同様にして、それぞれが、図 3 の X X 方向及び Y Y 方向に一致していることが望ましい。

【 0 0 9 6 】

また、図 2 1 (d) に示した液滴形状の谷部 2 0 d は、尖った一端 E 0 と緩やかに曲がる他端 E 1 とを略直線で結んだ平面形状を有し、且つ尖った先端 E 0 から緩やかに曲がる他端 E 1 にかけて徐々に寸法 D、この場合は谷の深さ D、が大きくなる断面形状を有する形状である。

【 0 0 9 7 】

この液滴形状の谷部 2 0 d に関しては、先端 E 0 から他端 E 1 にかけて存在する領域 W において、光源 S から出た光が角度 2θ で反射する傾向があり、これが、光反射膜の光指向性を決定する大きな因子となっている。そして、この場合の θ は、とりもなおさず、先端 E 0 から他端 E 1 にかけての傾斜角度 θ ということである。

【 0 0 9 8 】

以上の結果、光源 S を太陽光、室内光等といった外部光と考え、反射角度 2θ の反射光の先（パネル表示面の法線方向）に観察者の目が位置すると考えれば、液晶装置の表示面を観察者が見たときに外部光によって最も効率良く表示された、明るくて鮮明な像を観察者によって視認できると考えられる。

【 0 0 9 9 】

今、携帯電話機やその他の電子機器において、外部光と視認角度との間の上記の 2θ の反射角度を考えると、 $2\theta = 15^\circ$ 程度が実用的な角度であると思われる。このような 2θ 角度を実現するためには、谷部 2 0 d における先端 E 0 から他端 E 1 にかけての傾斜角度 θ を $\theta = 15^\circ / 2 = 7.5^\circ$ に設定すれば良い。

また、発明者の実験によれば、液滴形状の谷部 2 0 d に関しては、その深さ D 0 が約 $1\mu\text{m}$ 、その幅 W 0 が約 $9\mu\text{m}$ 、そして、その長さ L 0 が約 $14\mu\text{m}$ の場合に、好ましい光指向性及び光散乱性が得られた。なお、谷部 2 0 d 等は一般にはフォトリソグラフィ法等といったパターンニング法を用いて形成されるものであり、その深さ D 0 等に関しては、全ての谷部 2 0 d について全く等しい寸法に仕上げることは不可能であり、その寸法にばらつきが生じることは避けられない

【0100】

発明者がこのことに関して観察を行ったところ、図24に示すように、目標とする $1\mu\text{m}$ の深さ $D0$ を得ようとする場合、半値幅における寸法幅が $0.8\mu\text{m} \sim 1.2\mu\text{m}$ であるような正規分布が得られた。つまり、谷部20dの深さの目標を $1\mu\text{m}$ とした場合でも、60～80%程度の数の谷部はその深さが $D0 = 0.8\mu\text{m} \sim 1.2\mu\text{m}$ に形成され、さらに、20～40%程度の数の谷部はその深さが $D0 = 0.8\mu\text{m} \sim 1.2\mu\text{m}$ を外れる寸法に形成される。このような寸法のばらつきがある場合でも、光反射膜から良好な光指向性及び光散乱性が得られることが確認できた。

【0101】

(液晶装置用基板及び液晶装置の第4実施形態)

図23は、本発明に係る液晶装置の他の実施形態の主要部を示しており、先に説明した図2に対応する構造を示している。ここに示す実施形態では、光指向性及び光散乱性を有するパターンである、複数の山部10又は谷部20が平面内で規則的に並べられるのではなく、平面内で無秩序、すなわちランダムに並べられている。なお、各山部10又は谷部20の延在方向は、図2に示した実施形態の場合と同様に、各山部間又は谷部間で互いに同じ方向となっている。

【0102】

図2に示したように、複数の山部又は谷部を規則的なマトリクス状に並べると、光の干渉等といった不都合な光学現象が発生するおそれがある。これに対し、本実施形態のように、山部又は谷部等といった反射パターンを平面内で無秩序に並べれば、反射パターンの規則性によって誘起される不都合な光学現象を回避することができる。

【0103】

なお、山部10又は谷部20の互いに隣り合うもの同士のX方向の間隔 Gx は、山部10又は谷部20のX方向の長さを Lx としたとき、

$$Lx \leq Gx \leq Lx + \alpha x : \text{但し } a < \alpha x < b$$

に設定する。また、山部10又は谷部20の互いに隣り合うもの同士のY方向の

間隔 G_y は、山部 10 又は谷部 20 の Y 方向の長さを L_y としたとき、

$$L_y \leq G_y \leq L_y + \alpha_y : \text{但し } a < \alpha_y < b$$

に設定する。

【0104】

ここで、“a”はパターン同志がパターン形状を維持して最も近接できる距離であり、 $2\mu\text{m}$ 程度である。これ以下になると隣り合う山部10又は谷部20同士の間隔が狭くなり過ぎて谷部等の形が崩れて、光指向性及び光散乱性を実現する上で不十分になる。一方、“b”はパターン同志が隔離される最大距離を示すものであり、 $10\mu\text{m}$ 程度である。これ以上になると、隣り合う山部10又は谷部20同士の間隔が広くなり過ぎて平坦な部分が多くなるので、光指向性及び光散乱性を実現する上で不十分になる。これに対し、 G_x 及び G_y の寸法を上記のように設定すれば、そのような心配が無くなる。

【0105】

(液晶装置用基板の製造方法の第2実施形態)

図26は、本発明に係る液晶装置用基板の製造方法の他の実施形態の主要工程を示しており、特に、図9に示すようにガラス等から成る基材6a上に谷部を備えた光反射膜を形成する場合の形成方法の一実施形態を示している。

【0106】

ここに示す光反射膜の形成工程では、まず、図26の工程P31及び図27(a)において、ガラス等から成る基材6a上に第1層46を一様な厚さで塗布する。例えば、粘度9cPのアクリル樹脂を800rpmで10秒間のスピncートによって $1.6\mu\text{m}$ 程度で塗布した。

【0107】

次に、工程P32においてプリベークを行って第1層を固定した。例えば、ホットプレート上で 100°C 、2分でプリベークを行った。次に、工程P33及び図27(b)において、目標とする谷部に対応したマスクパターン47が形成されたマスク48を通して第1層46をi線(すなわち、波長365nmの光)で露光した。このとき、マスク48と第1層46との間の距離、すなわちプロキシミティ・ギャップ G_p は $G_p = 60\mu\text{m}$ とした。また、i線の露光量は一括露光

で 8 0 m J、4 秒とした。

【0 1 0 8】

第 1 層 4 6 を形成するアクリル樹脂はポジ型の感光性樹脂であり、上記の露光により、第 1 層 4 6 のうちマスクパターン 4 7 に対応する部分が可溶性を呈することになった。次に、工程 P 3 4 において現像処理を行うことにより、図 2 7 (c) に示すように第 1 層 4 6 がパターニングされた。このパターニングによって第 1 層 4 6 が除去された部分 K が後で光反射膜の谷部となる部分である。

【0 1 0 9】

次に、工程 P 3 5 においてポスト露光、例えば i 線を 3 0 0 m J で短時間全面照射することにより、第 1 層 4 6 を形成するアクリル樹脂の色を消去した。またその後、工程 P 3 6 においてポストバーク、例えばホットプレートで 2 2 0 ℃、5 0 分間の加熱を行うことにより、第 1 層 4 6 を固めた。

【0 1 1 0】

次に、工程 P 3 7 及び図 2 7 (d) において、第 1 層 4 6 の上に第 2 層 4 9 を一様に塗布した。この第 2 層 4 9 は、例えば第 1 層 4 6 と同じアクリル樹脂を、1 0 0 0 r p m で 1 0 秒間スピコートすることによって、厚さ 1. 3 μ m 程度に形成した。

【0 1 1 1】

次に、工程 P 3 8 においてプリバークを行って第 2 層を固定した。例えば、ホットプレート上で 1 0 0 ℃、2 分でプリバークを行った。次に、工程 P 3 9 及び図 2 7 (d) において、周辺部分が開口したマスク 5 1 を通して第 2 層 4 9 を i 線（すなわち、波長 3 6 5 n m の光）で露光した。このとき、マスク 4 9 と第 2 層 4 9 との間の距離、すなわちプロキシミティ・ギャップ G_p は $G_p = 1 2 0 \mu$ m とした。また、i 線の露光量は一括露光で 1 0 0 m J、5 秒とした。このときの露光により、駆動用 I C 等を実装するための周辺領域の第 2 層 4 9 を除去した。

【0 1 1 2】

第 2 層形成時の i 線露光におけるプロキシミティ・ギャップ G_p は $G_p = 1 2 0 \mu$ m である。一方、第 1 層形成時の i 線露光におけるプロキシミティ・ギャッ

プロキシミティ・ギャップ G_p は $G_p = 60 \mu m$ である。つまり、谷部を形成するための第 1 層の露光時におけるプロキシミティ・ギャップ G_p は、第 2 層の周辺露光を行う際のプロキシミティ・ギャップ G_p よりも小さく設定している。

【 0 1 1 3 】

原理的に言えば、プロキシミティ・ギャップ G_p は、それを小さくすればする程、パターンを精密に形成することができる。ところが、プロキシミティ・ギャップ G_p を小さくし過ぎると、マスクと露光対象物との間に異物が存在するときにマスク等がその異物によって損傷するおそれがあるので、プロキシミティ・ギャップ G_p を小さくすることについては限界がある。

【 0 1 1 4 】

以上の理由から、本実施形態では、谷部の基礎となる第 1 層 4 6 の露光時におけるプロキシミティ・ギャップ G_p はできる限り小さく、本実施形態では $60 \mu m$ に設定し、それ程精密さを必要としない第 2 層の露光時におけるプロキシミティ・ギャップ G_p はできる限り大きく、本実施形態では $120 \mu m$ に設定してある。

【 0 1 1 5 】

次に、工程 P 4 0 において現像処理を行って周辺部に存在する第 2 層 4 9 を除去することにより、図 2 7 (e) に示すように、谷部に対応する部分が窪んだ状態の第 2 層 4 9 が得られた。次に、工程 P 4 1 においてポスト露光、例えば i 線を $300 mJ$ で短時間全面照射することにより、第 2 層 4 9 を形成するアクリル樹脂の色を消去した。またその後、工程 P 4 2 においてポストバーク、例えばクリーンオープンで $220^\circ C$ 、50 分間の加熱を行うことにより、第 2 層 4 9 を固めた。

【 0 1 1 6 】

その後、工程 P 4 3 において、反射膜材料、例えば Al (アルミニウム) を例えばスパッタ法によって $0.2 \mu m$ 程度の一様な厚さで成膜し、さらに、工程 P 4 4 においてフォトリソエッチング処理を行って、図 2 7 (f) において所定模様の反射膜 5 2 を形成した。このときのパターニングは、液晶装置においてバックライトを用いた透過方式の表示を行うときの光透過用の開口を形成したり、液晶パ

ネルの周辺部に電子部品等を実装するための領域を確保したりする等のために行われるものである。

【0117】

以上により、図28に示すように、谷部20が目標のパターン、例えば無秩序に配列された状態の反射膜52が形成された。本実施形態のように、反射膜52の下地層を第1層46及び第2層49から成る2段の積層構造とすれば、谷部20同士の間領域を平坦でない湾曲面又は粗面に形成することができ、これにより、反射膜52において鏡面反射が発生することを防止して、希望する光散乱を確実に得ることができる。

【0118】

なお、以上の説明では、図9に示すような半透過反射型の液晶装置において、スイッチング素子が形成された基板と反対側の基板に光反射膜を形成する場合を例示したが、図26に示す反射膜の形成工程は、図1に示すような液晶装置、すなわちスイッチング素子が形成される基板と同じ基板上に光反射膜を形成する場合にも、もちろん、適用できる。但し、図1に示す光反射膜を形成する場合には、コンタクトホール26を形成するための工程等が別途必要になる。

【0119】

(電子機器の実施形態)

図29は、本発明に係る電子機器の一例である携帯電話機の一実施形態を示している。この携帯電話機100は、表示部としての液晶装置101と、アンテナ102と、スピーカ103と、キースイッチ群104と、マイクロホン105とを有する。

【0120】

液晶装置101は、筐体としての外装ケースに収納されると共に、外装ケースの内部に設けた制御回路106によって制御されて、電話通信内容やインターネット情報等を表示する。この液晶装置101は、例えば、図3に示した液晶装置1を用いて構成できる。

【0121】

図30は、本発明に係る電子機器の一例である腕時計の一実施形態を示してい

る。この腕時計 1 1 0 は表示部として液晶装置 1 1 1 を有している。この液晶装置 1 1 1 は、筐体としての外装ケースに収納されると共に、外装ケースの内部に設けた制御回路 1 1 2 によって制御されて、時刻、日付等を情報として表示する。この液晶装置 1 1 1 は、例えば、図 3 に示した液晶装置 1 を用いて構成できる。

【 0 1 2 2 】

図 3 1 は、本発明に係る電子機器の一例である携帯型情報処理装置の一実施形態を示している。この携帯型情報処理装置 1 2 0 は、例えば、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータ等として提供されるものである。ここに示す携帯型情報処理装置 1 2 0 は、本体 1 2 1 の表面に設けられたキーボード等といった入力装置 1 2 2 と、表示部としての液晶装置 1 2 3 とを有する。本体 1 2 1 の内部に配設されたプロセッサの処理により、キーボード 1 2 2 を通して入力された情報や、その情報に基づく何等かの演算処理の結果が液晶装置 1 2 3 に表示される。

図 3 2 は、本発明に係る電子機器の他の実施形態を示している。ここに示す電子機器は、表示情報出力源 1 3 0、表示情報処理回路 1 3 1、電源回路 1 3 2、タイミングジェネレータ 1 3 3、液晶装置 1 3 4、及び駆動回路 1 3 6 により構成される。

【 0 1 2 3 】

このうち、表示情報出力源 1 3 0 は、RAM(Random Access Memory)等といったメモリや、各種ディスク等といったストレージユニットや、デジタル画像信号を同調出力する同調回路等を備え、タイミングジェネレータ 1 3 3 により生成される各種のクロック信号に基づいて、所定フォーマット画像信号等といった表示情報を表示情報処理回路 1 3 1 に供給する。

【 0 1 2 4 】

次に、表示情報処理回路 1 3 1 は、増幅・反転回路や、ローテーション回路や、ガンマ補正回路や、クランプ回路等といった周知の回路を多数備え、入力した表示情報の処理を実行して、画像信号をクロック信号 CLK と共に駆動回路 1 3 6 へ供給する。ここで、駆動回路 1 3 6 は、走査線駆動回路（図示せず）やデータ線駆動回路（図示せず）と共に、検査回路等を総称したものである。また、電

源回路 1 3 2 は、上記の各構成要素に所定の電源電圧を供給する。

【0 1 2 5】

（その他の実施形態）

以上、好ましい実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明はその実施形態に限定されるものでなく、請求の範囲に記載した発明の範囲内で種々に改変できる。

【0 1 2 6】

例えば、以上に説明した実施形態では反射パターンを構成する山部や谷部を規定する直交 2 軸を液晶装置 1 の基板の端辺が延在する方向 X X 及び Y Y に平行となるように設定したが、これに代えて、反射パターンに関する直交 2 軸方向と基板の端辺方向とに適宜の角度を持たせても良い。

【0 1 2 7】

また、図 3 に示した液晶装置 1 は単なる例示であり、本発明に係る液晶装置用基板を適用できる液晶装置は図 3 に示す構造以外の任意の液晶装置とすることができる。

【0 1 2 8】

【発明の効果】

本発明に係る液晶装置用基板、液晶装置及びそれらの製造方法並びに電子機器によれば、液晶装置の内部に入射した光を光反射膜によって反射させる際に、立体空間の全方位へ均一に反射するのではなく、特定の視野方向の光量又は強度が強くなるように反射できる。これにより、反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることができ、これにより、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明に係る液晶装置用基板の一実施形態及びその液晶装置用基板を用いて構成される液晶装置の一実施形態の主要部の断面構造を示す断面図である。

【図 2】

図 1 で用いられる液晶装置用基板の主要部の平面図である。

【図 3】

本発明に係る液晶装置の一実施形態を示す斜視図である。

【図 4】

本発明に係る液晶装置の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図 5】

本発明に係る液晶装置用基板の製造方法の一実施形態を示す工程図である。

【図 6】

図 5 に示す工程図に対応する基板の形成手順を示す図である。

【図 7】

図 5 の製造方法で用いられるマスクの一例を示す平面図である。

【図 8】

本発明に係る液晶装置用基板の他の実施形態及びその液晶装置用基板を用いて構成される液晶装置の他の実施形態の主要部の構造を示す斜視図である。

【図 9】

図 8 の主要部の断面構造を示す断面図である。

【図 1 0】

図 8 の液晶装置で用いられるアクティブ素子の一例である T F D 素子を示す斜視図である。

【図 1 1】

光反射膜の表面に形成する山部の例を示す図である。

【図 1 2】

光反射膜の表面に形成する山部の他の例を示す図である。

【図 1 3】

光反射膜の表面に形成する山部又は谷部によってもたらされる反射光の光量分布の一例を示すグラフである。

【図 1 4】

従来の液晶装置用基板の一例を示す図である。

【図 1 5】

本発明に係る液晶装置用基板に形成する山部を説明するための図である。

【図 1 6】

図 1 5 に示す山部を備えた反射パターンによってもたらされる反射光の光量分布の一例を示すグラフである。

【図 1 7】

反射光の光量分布を測定するための測定系の一例を示す斜視図である。

【図 1 8】

図 1 7 の測定系を用いて得られる反射光の光量分布の従来の一例を示すグラフである。

【図 1 9】

反射光の指向性及び散乱性を説明するための模式図である。

【図 2 0】

光反射膜の表面に形成する谷部の例を示す図である。

【図 2 1】

光反射膜の表面に形成する谷部の他の例を示す図である。

【図 2 2】

光反射膜の表面に形成する谷部のさらに他の例を示す図である。

【図 2 3】

本発明に係る液晶装置用基板の他の実施形態の平面構造の主要部を示す平面図である。

【図 2 4】

光反射膜の表面に形成する山部の高さ又は谷部の深さの寸法の分布状態を示す分布図である。

【図 2 5】

山部が形成された光反射面の現実の表面状態を模式的に示す断面図である。

【図 2 6】

本発明に係る液晶装置用基板の製造方法の他の実施形態を示す工程図である。

【図 2 7】

図 2 6 の工程図に対応して光反射膜の形成過程を示す図である。

【図 2 8】

完成した光反射膜の一例の断面構造を示す断面図である。

【図 2 9】

本発明に係る電子機器の一実施形態を示す斜視図である。

【図 3 0】

本発明に係る電子機器の他の実施形態を示す斜視図である。

【図 3 1】

本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態を示す斜視図である。

【図 3 2】

本発明に係る電子機器のさらに他の実施形態の電気制御系を示すブロック図である。

【符号の説明】

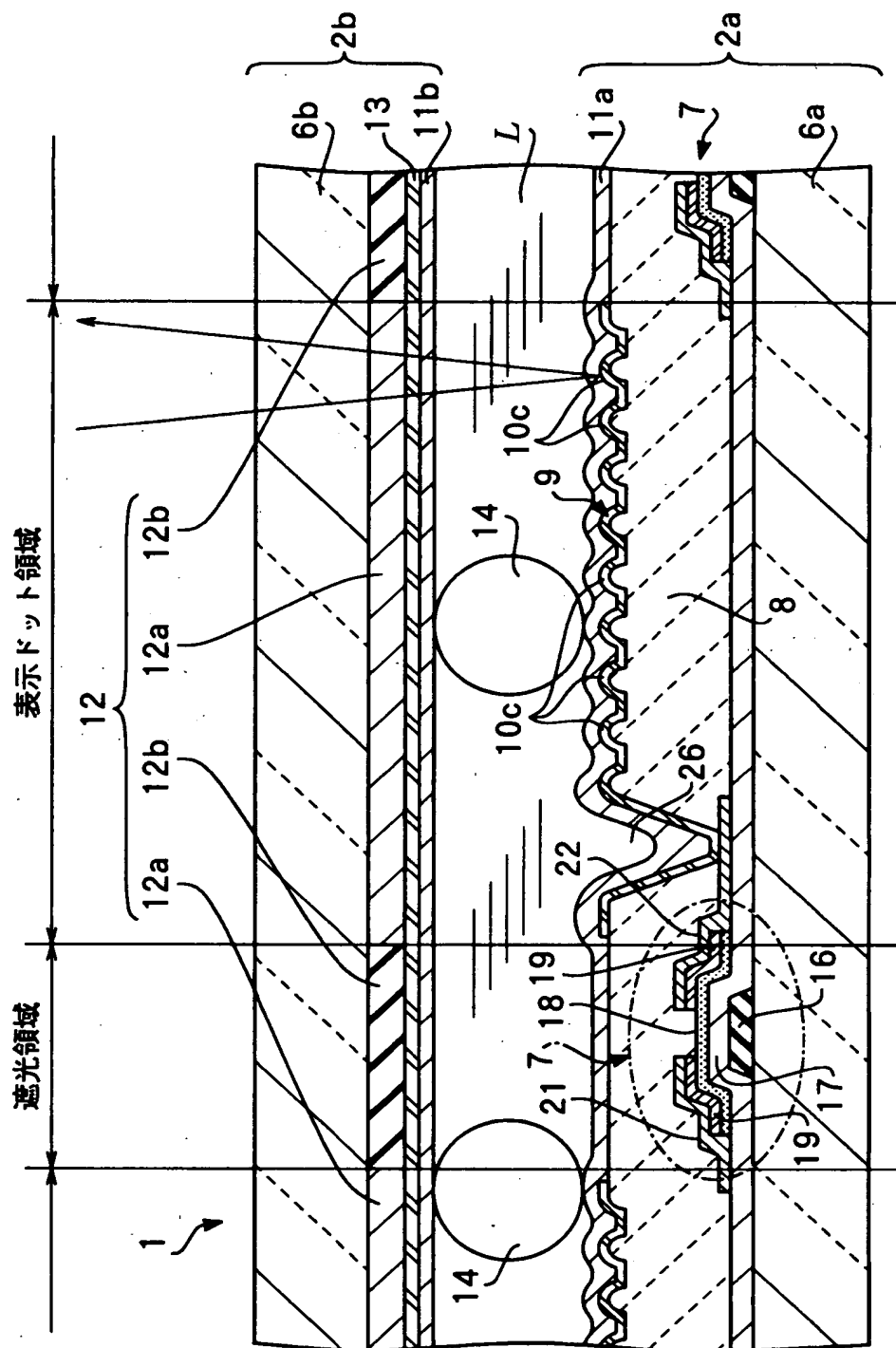
| | |
|--|-----------|
| 1 | 液晶装置 |
| 2 a, 2 b | 基板 |
| 3 | シール材 |
| 4 a, 4 b | 液晶駆動用 I C |
| 6 a, 6 b | 基板 |
| 7 | T F T |
| 8 | 有機絶縁膜 |
| 9 | 画素電極 |
| 1 0, 1 0 a, 1 0 b, 1 0 c, 1 0 d, 1 0 e | 山部 |
| 1 3 | 電極 |
| 2 0, 2 0 a, 2 0 b, 2 0 c, 2 0 d, 2 0 e | 谷部 |
| 2 8 | マスク |
| 2 9 | マスクパターン |
| 3 1 | 光反射膜 |
| 3 7 | T F D |
| 4 6 | 第 1 層 |
| 4 7 | マスクパターン |

| | |
|-------|-----------------|
| 4 8 | マスク |
| 4 9 | 第 2 層 |
| 5 1 | マスク |
| 5 2 | 反射膜 |
| 1 0 0 | 携帯電話機（電子機器） |
| 1 1 0 | 腕時計（電子機器） |
| 1 2 0 | 携帯型情報処理装置（電子機器） |
| L | 液晶 |
| S | 光源 |

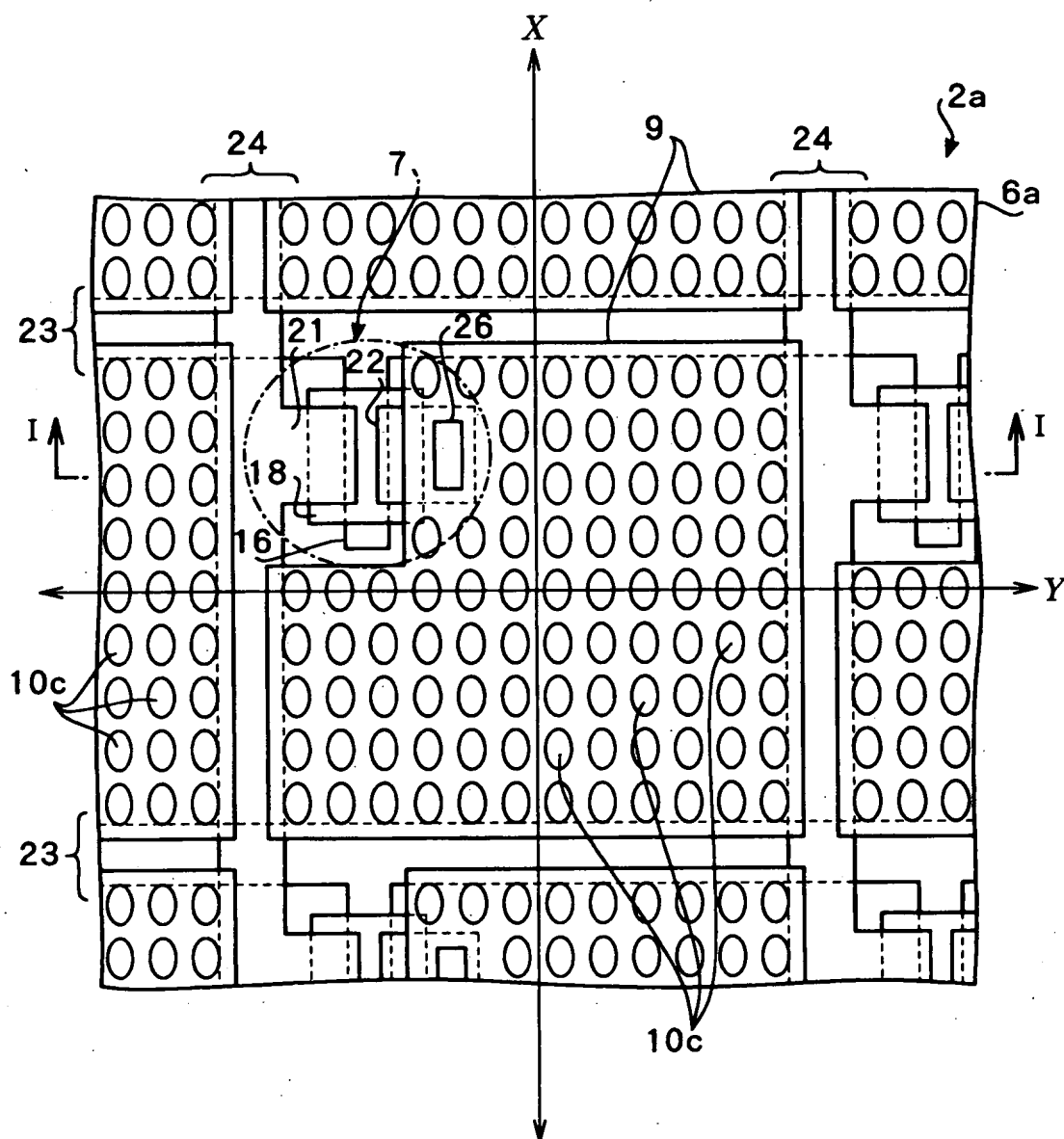
【書類名】

図面

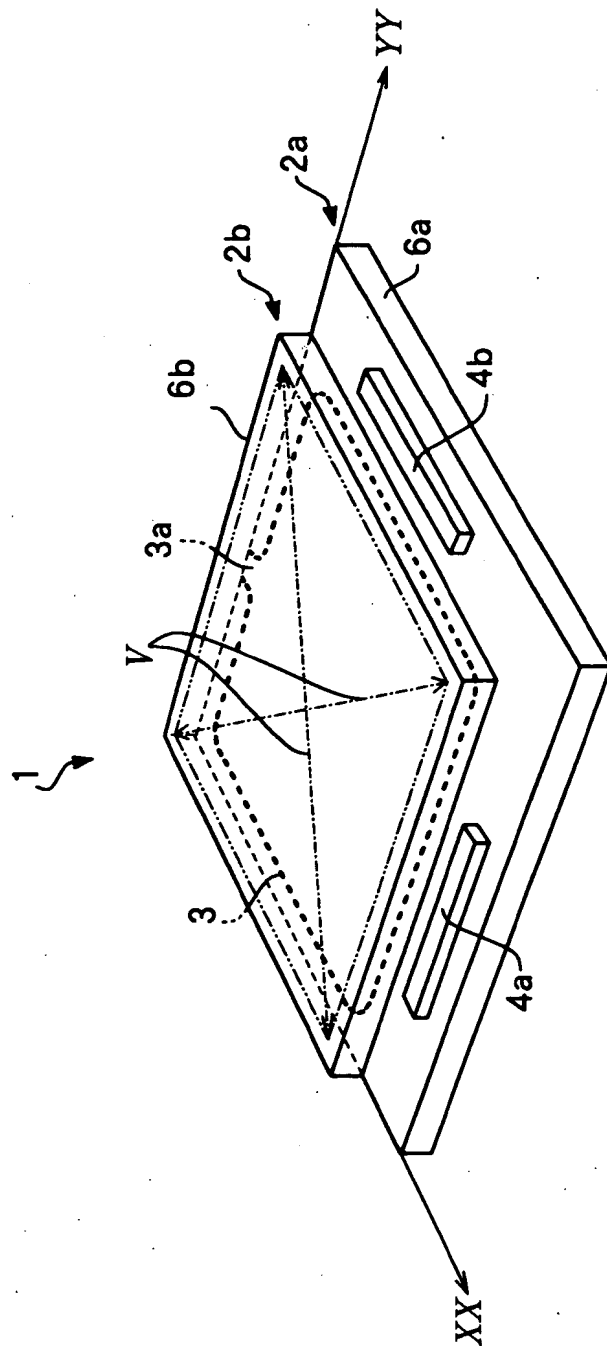
【図 1】



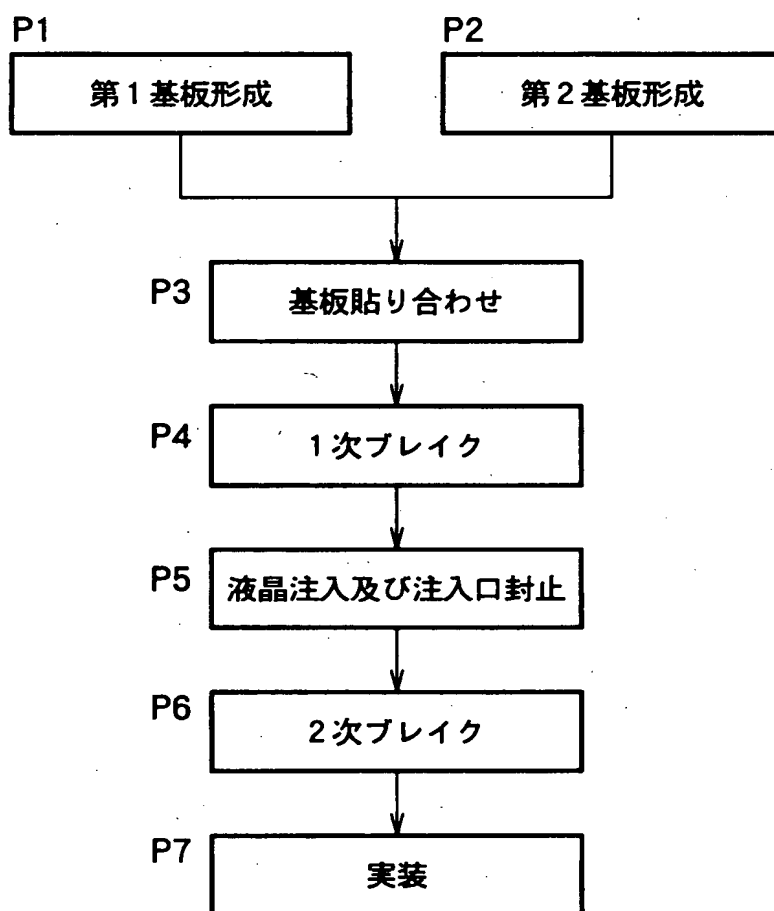
【図 2】



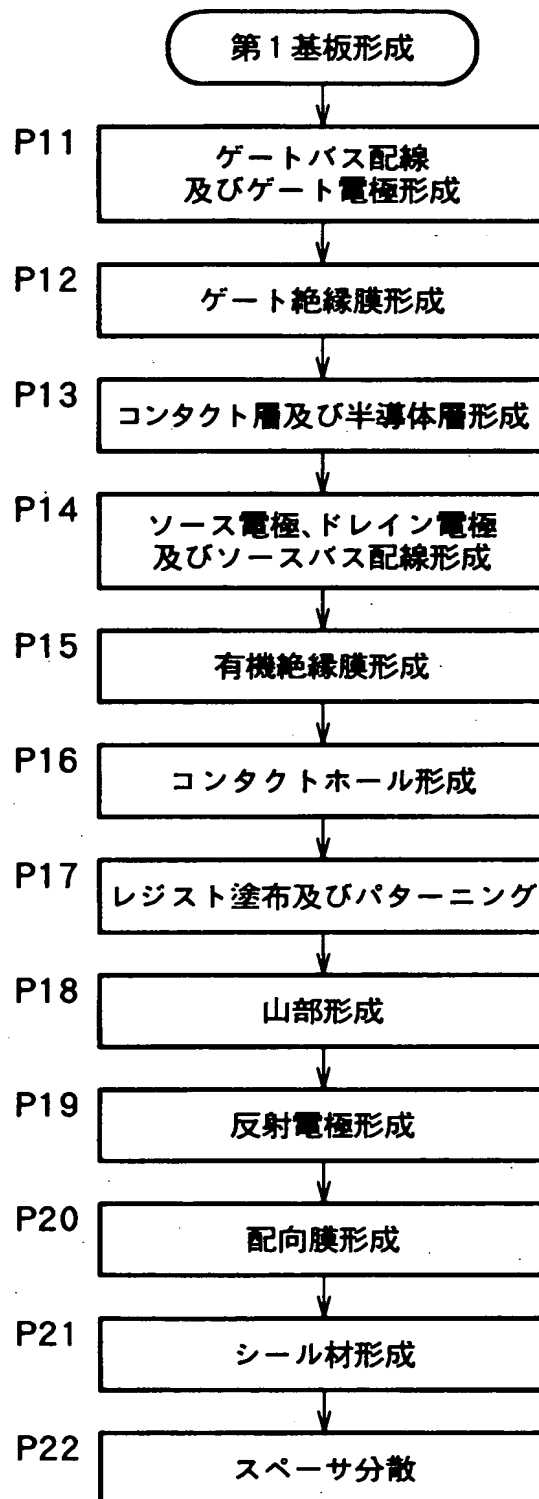
【図 3】



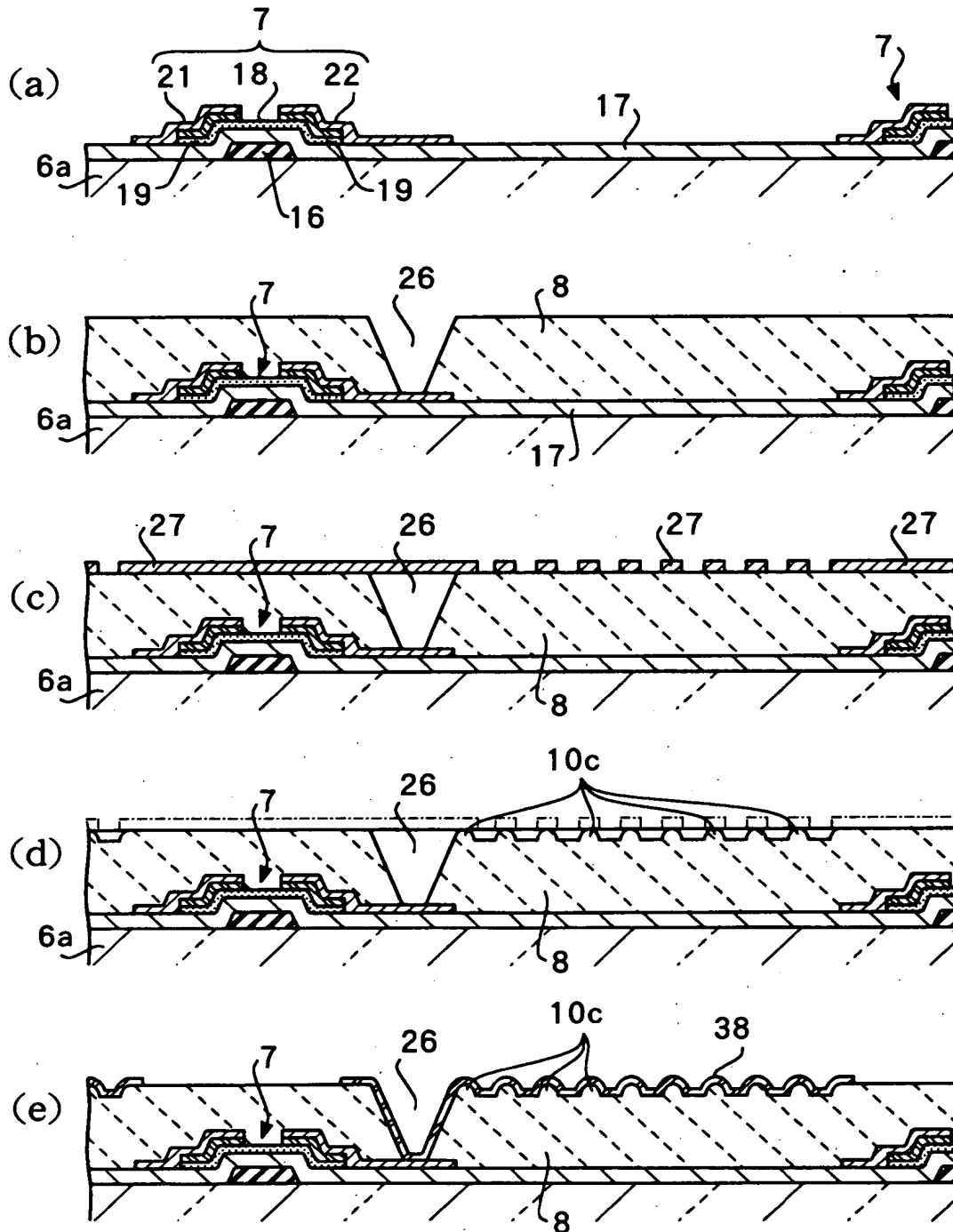
【図4】



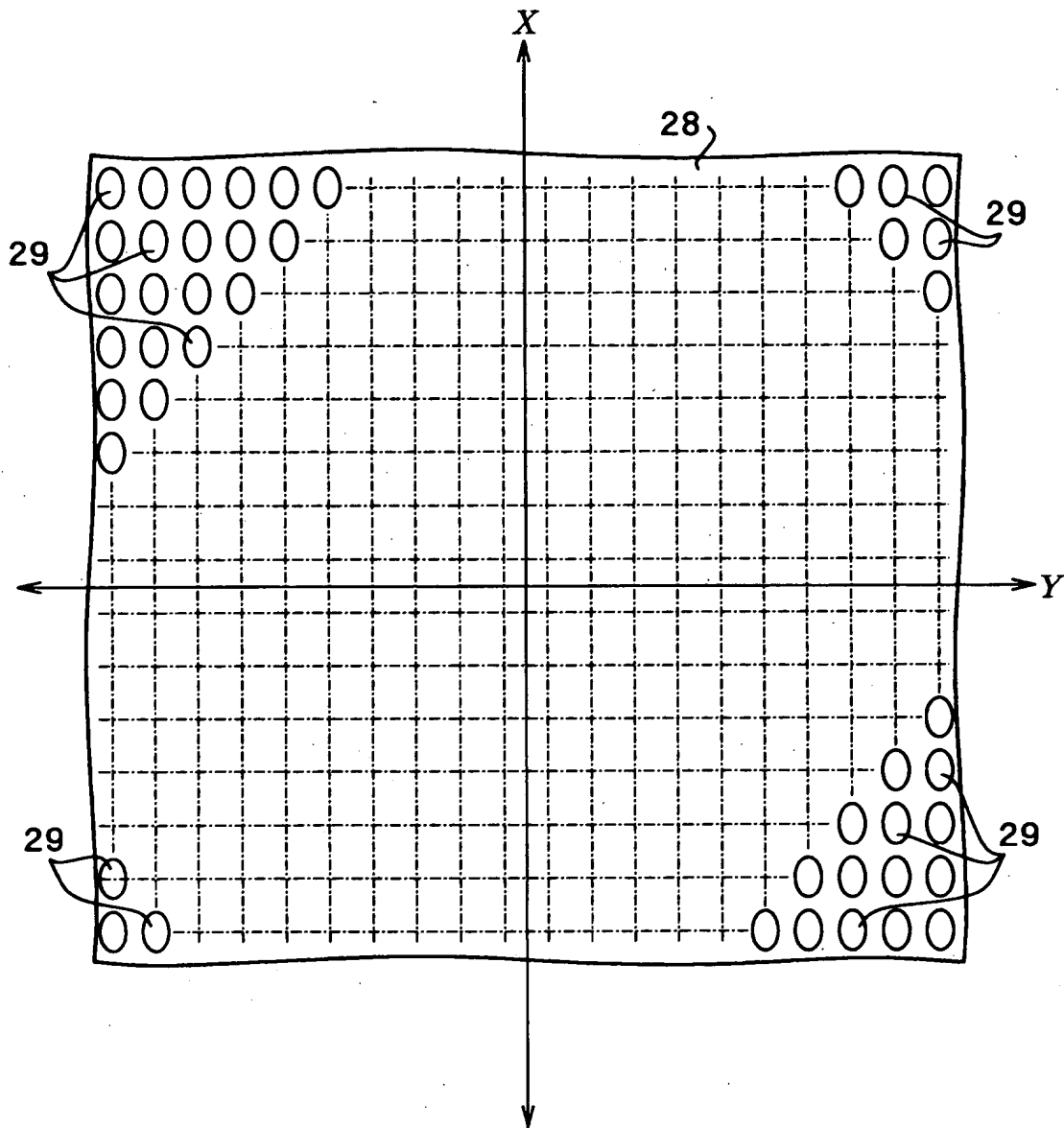
【図 5】



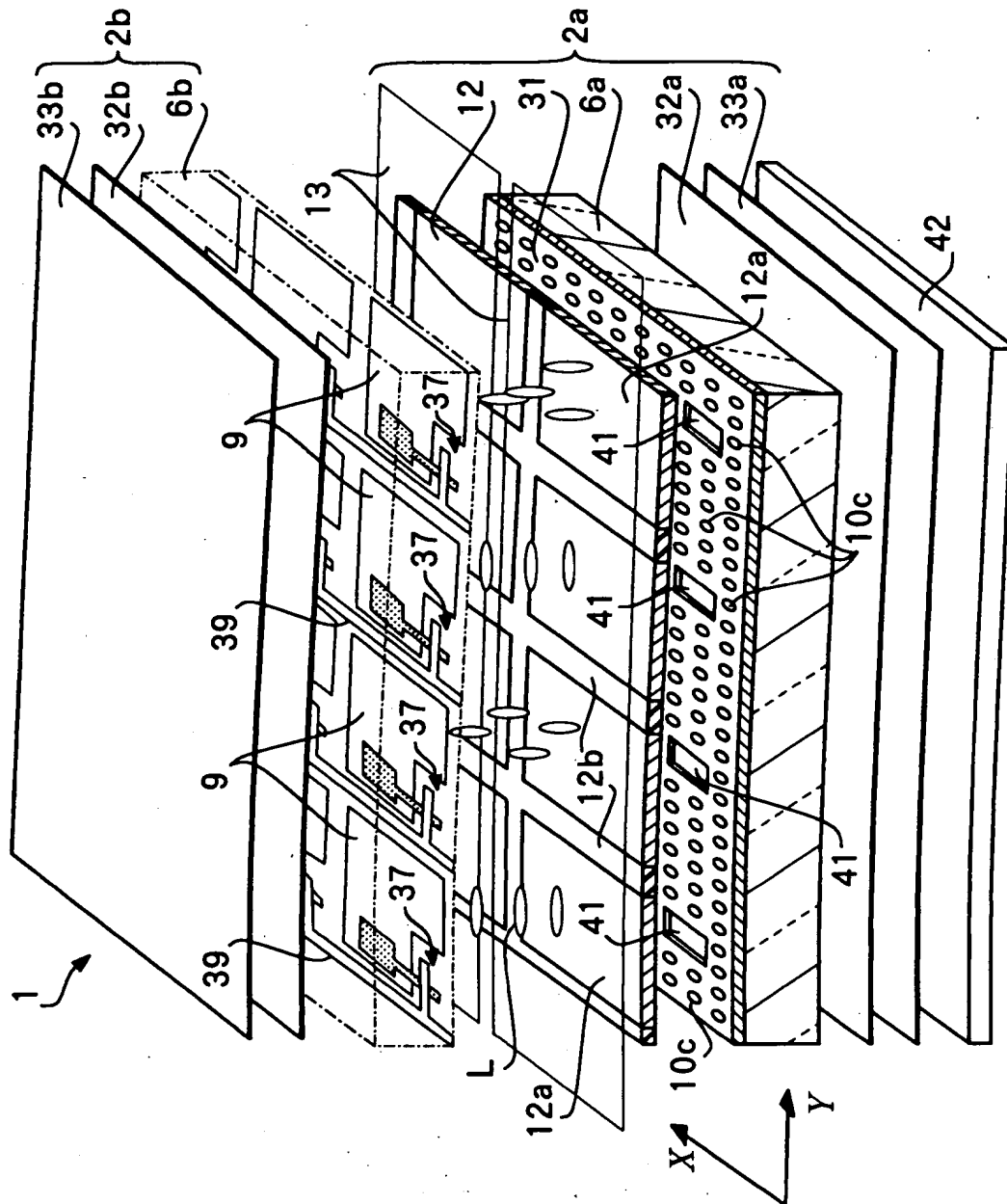
【図6】



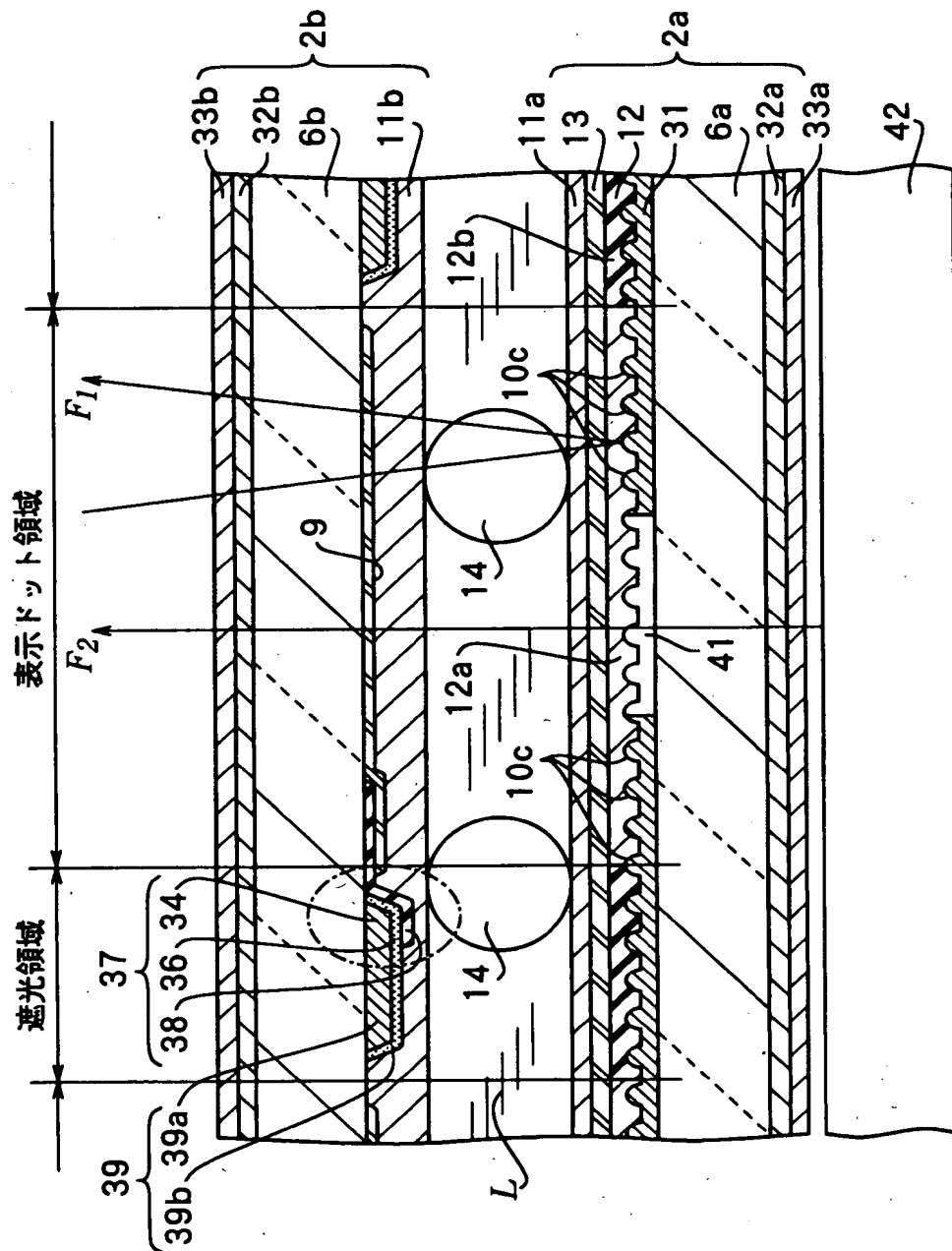
【図 7】



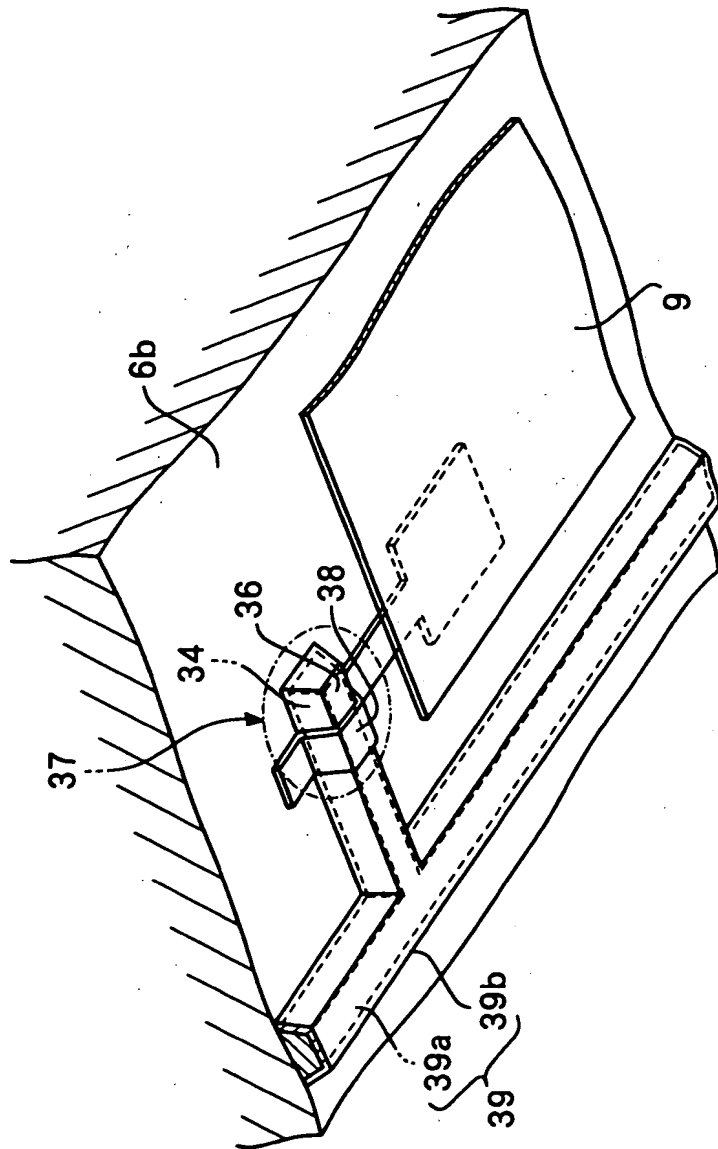
【図 8】



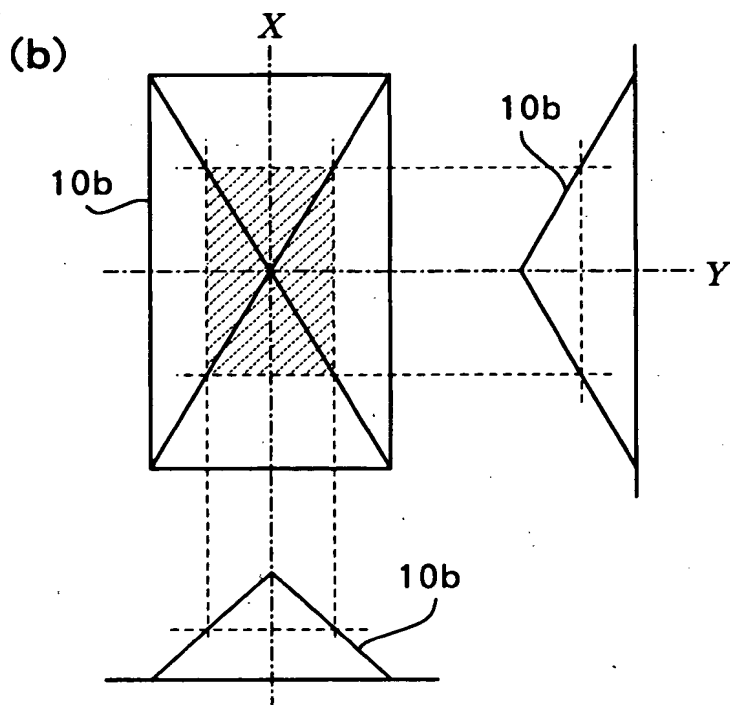
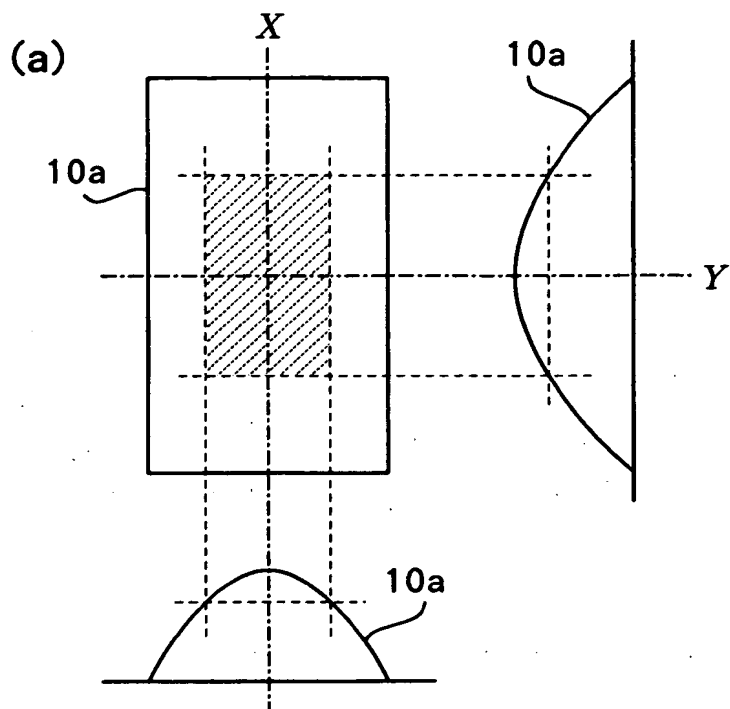
【図 9】



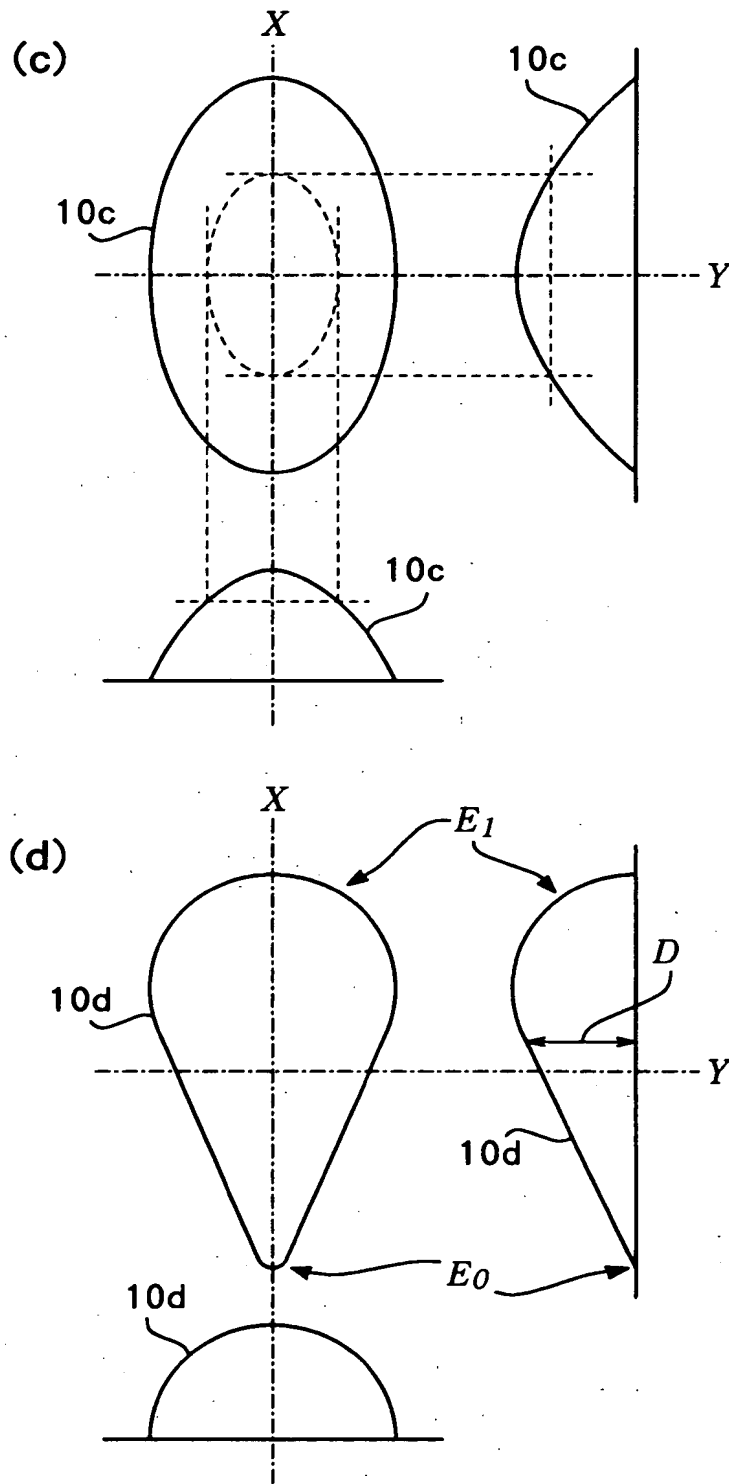
【図10】



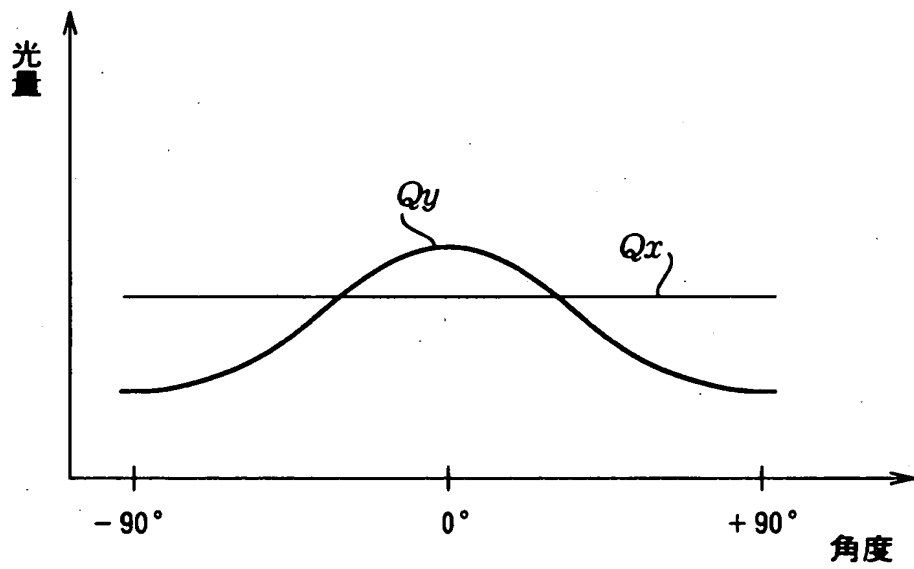
【図 11】



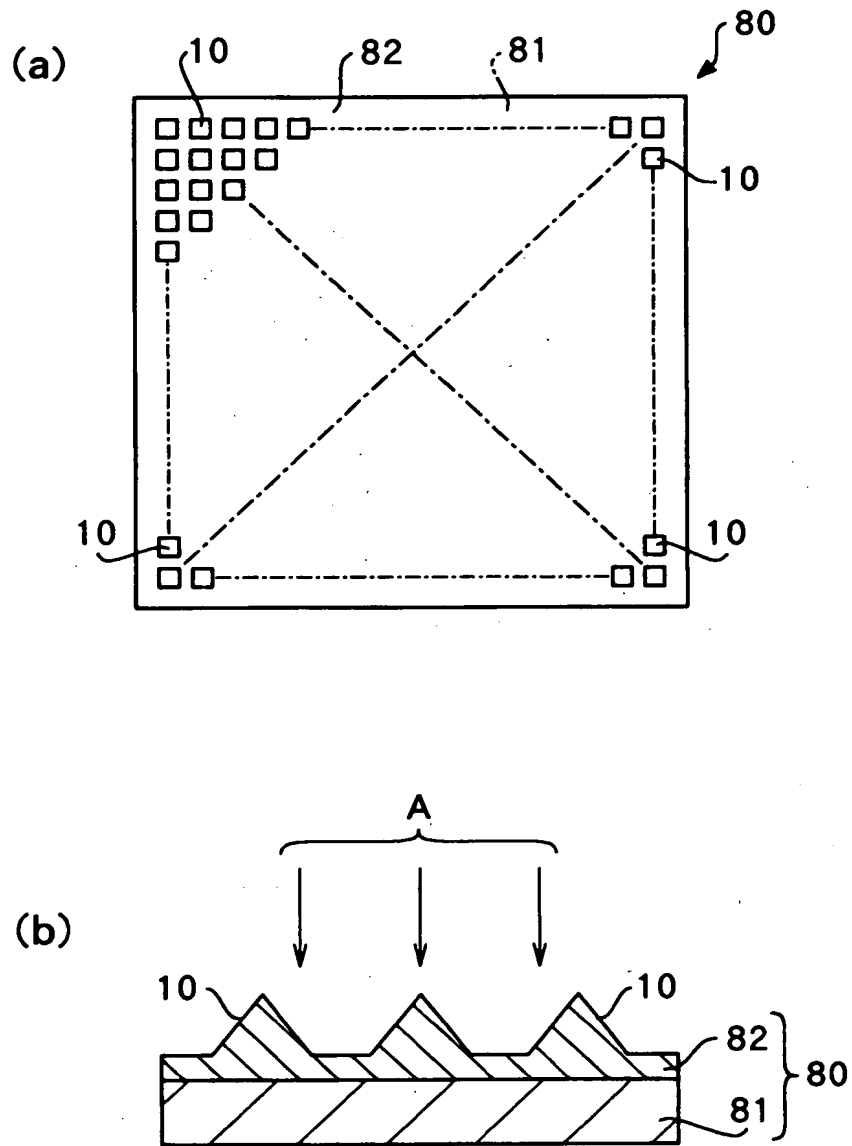
【図 12】



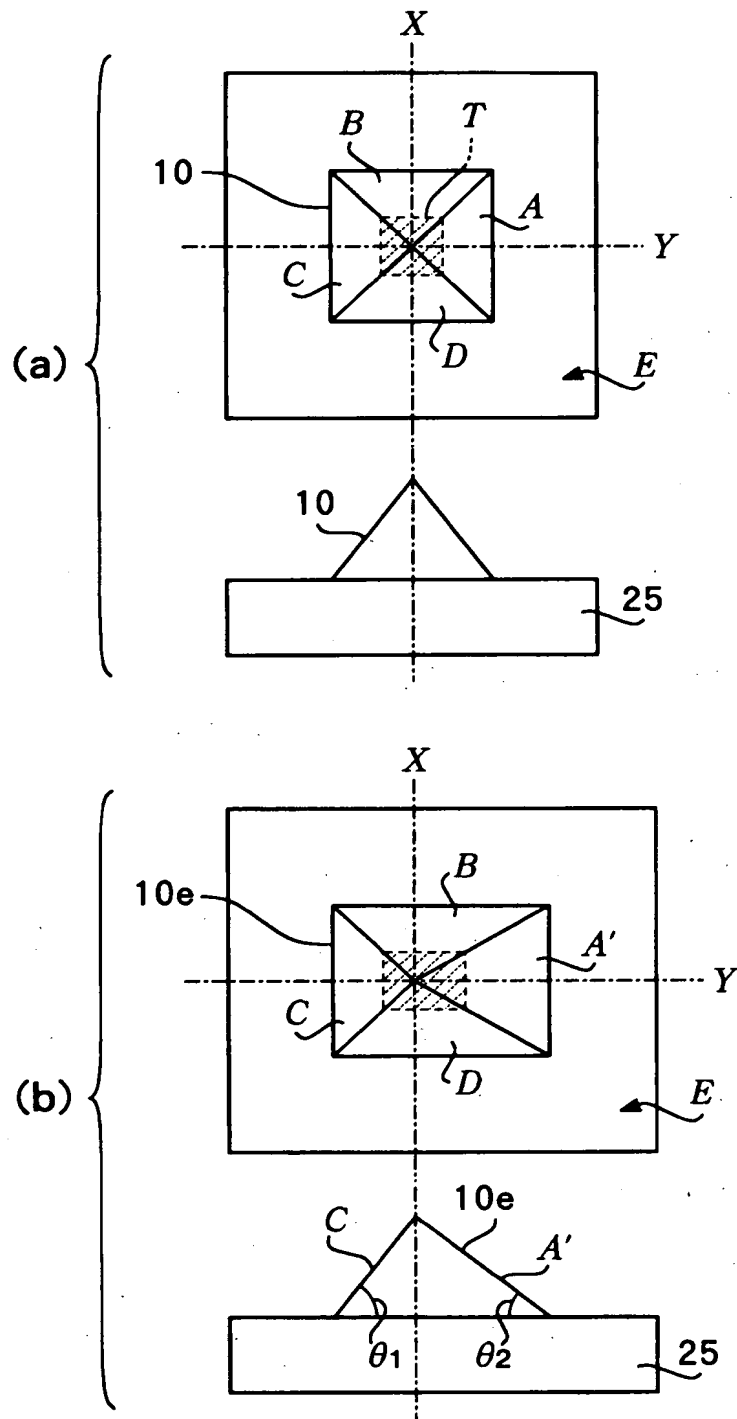
【図 13】



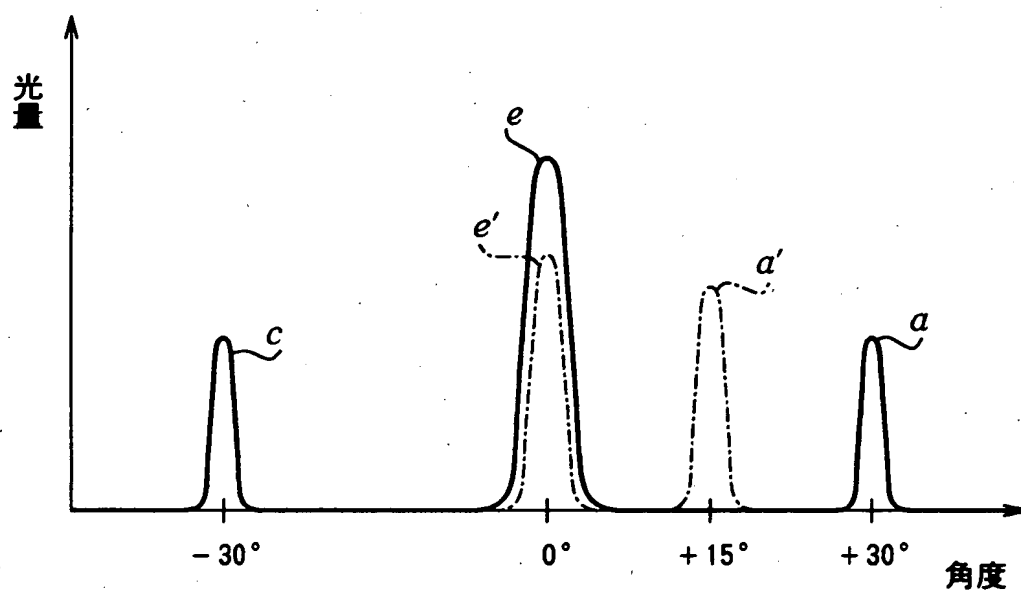
【図 14】



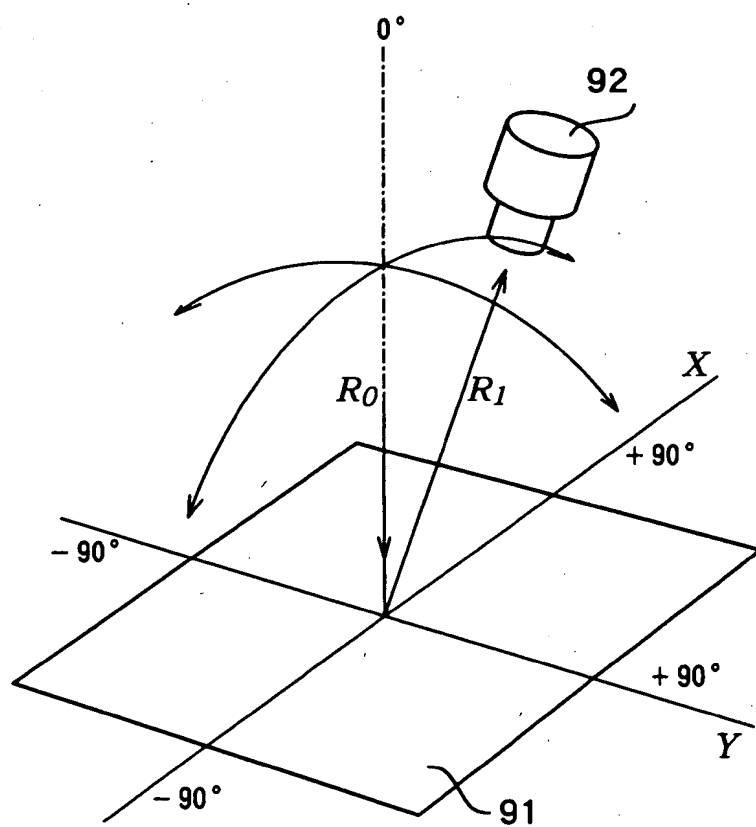
【図 15】



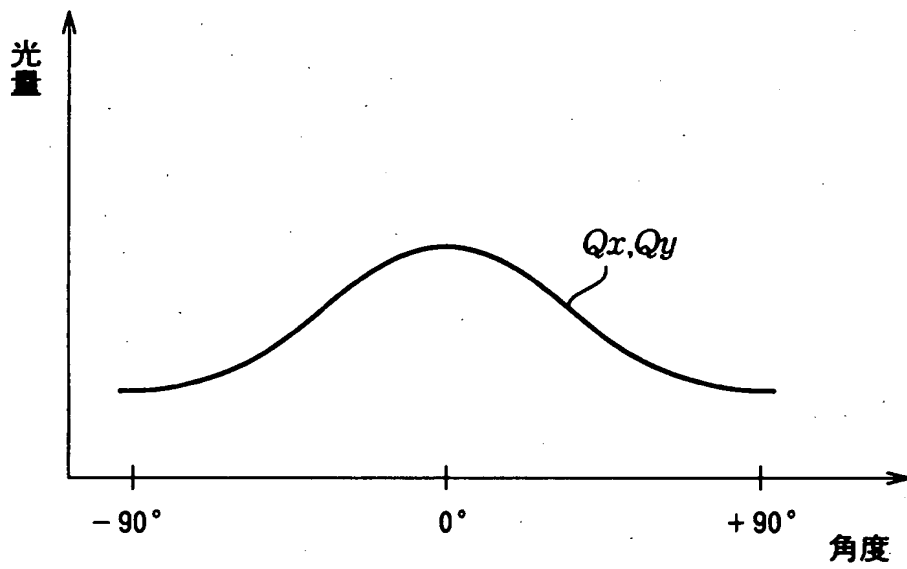
【図 16】



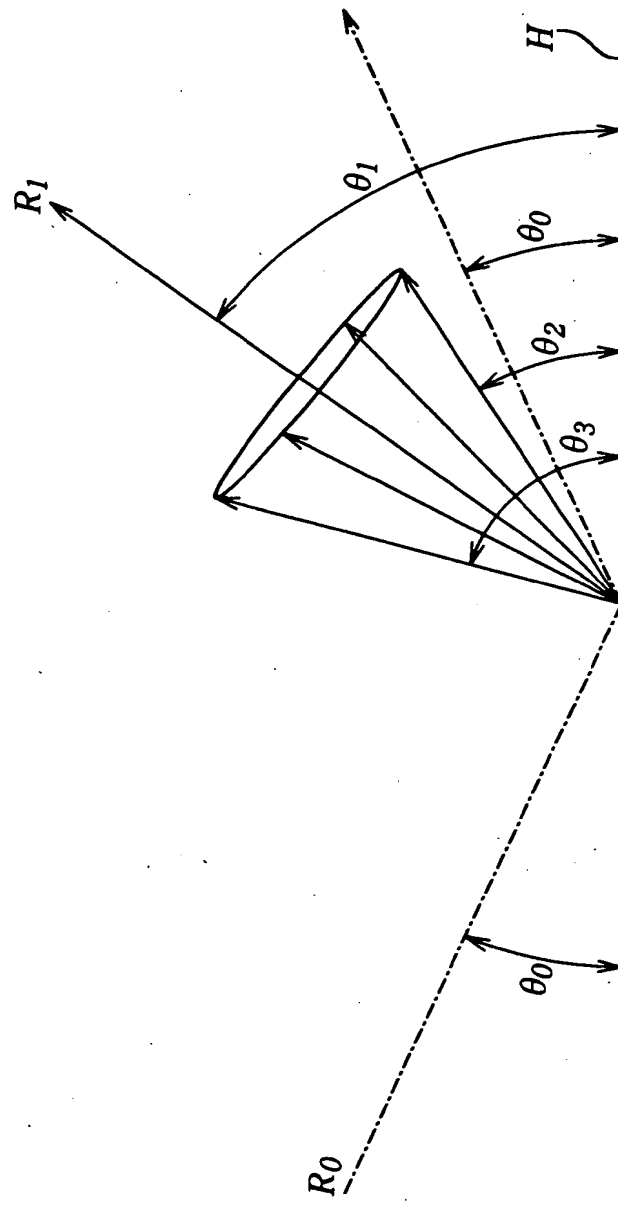
【図 17】



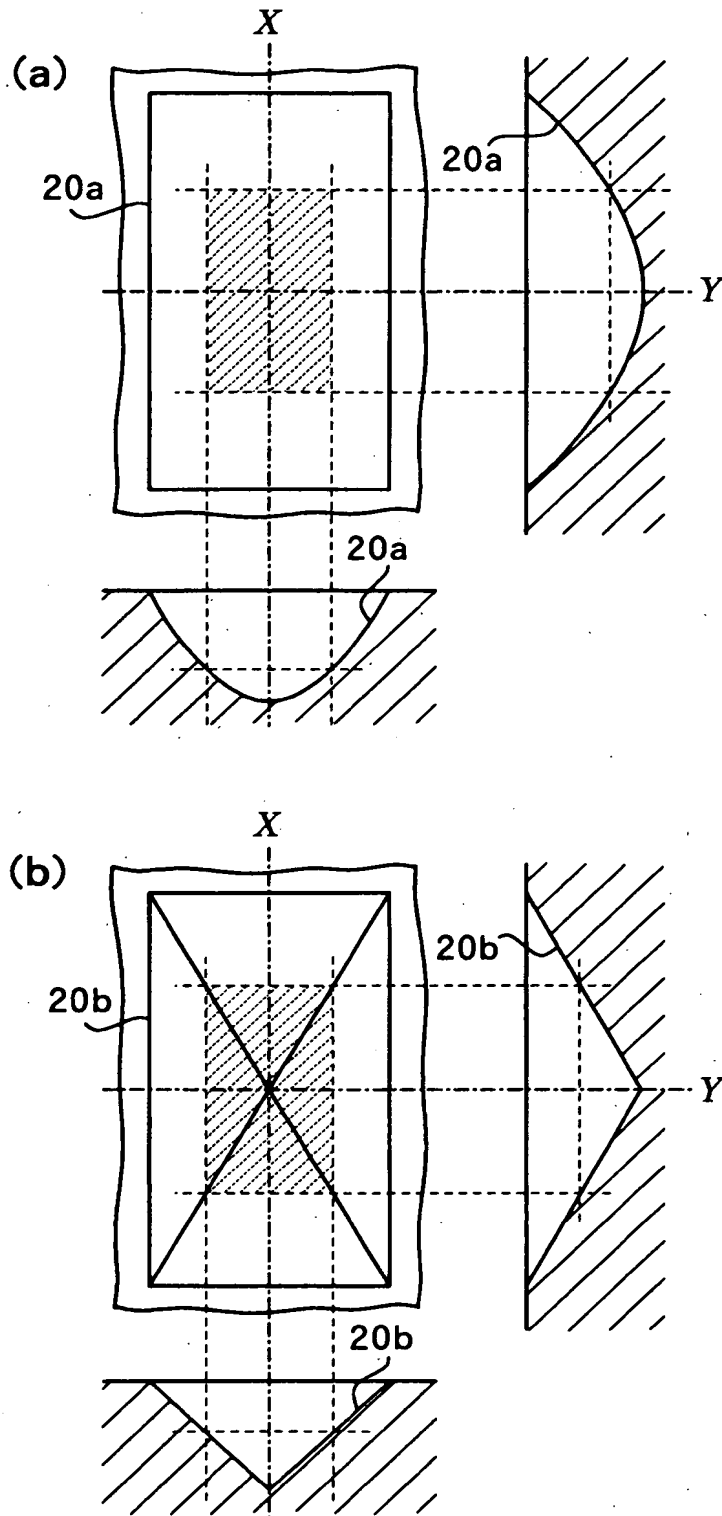
【図18】



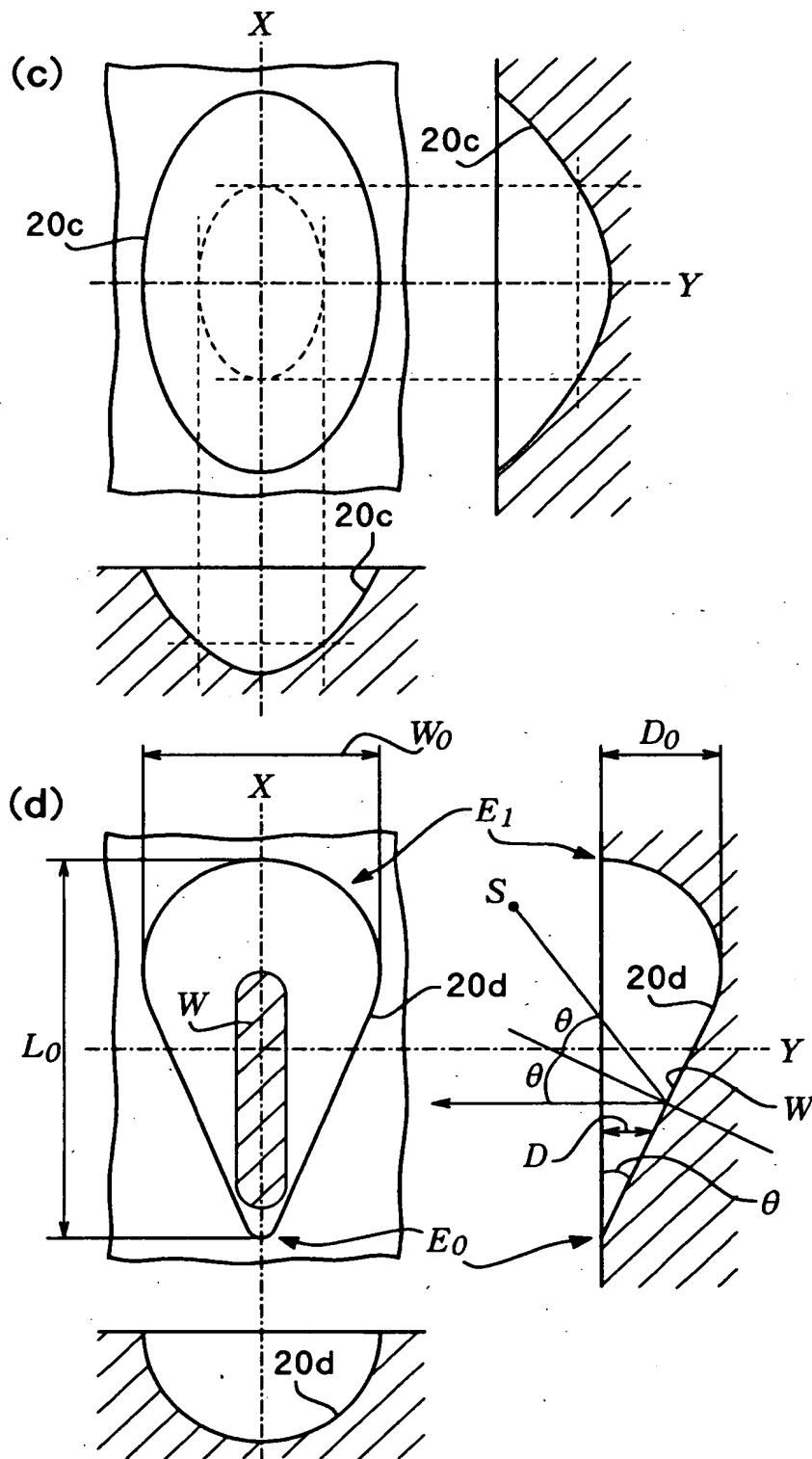
【図 19】



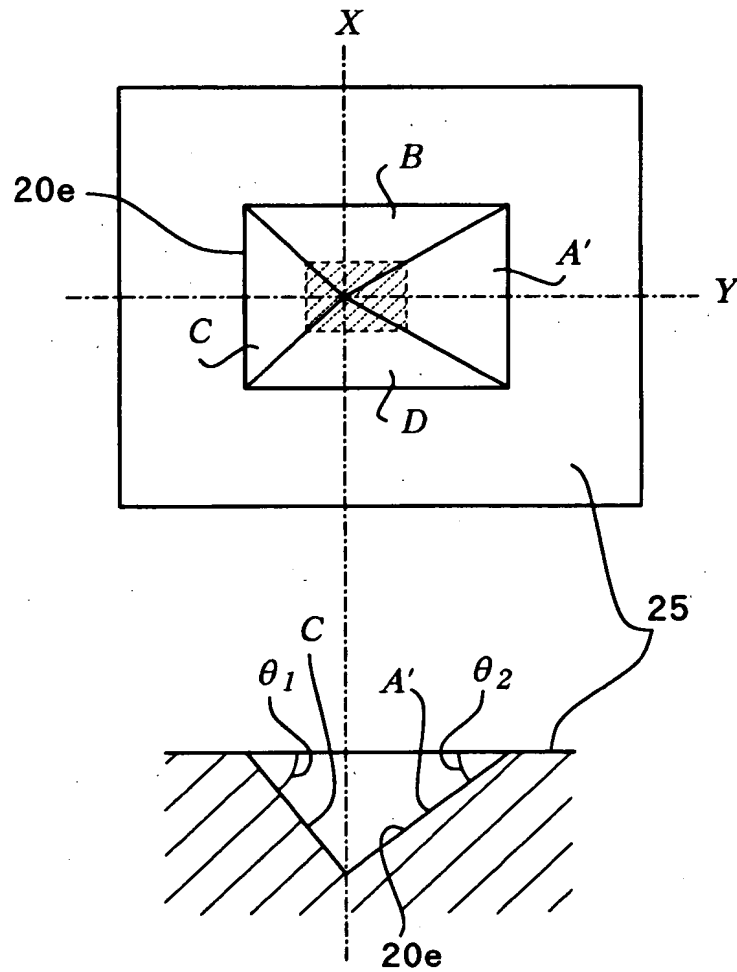
【図 20】



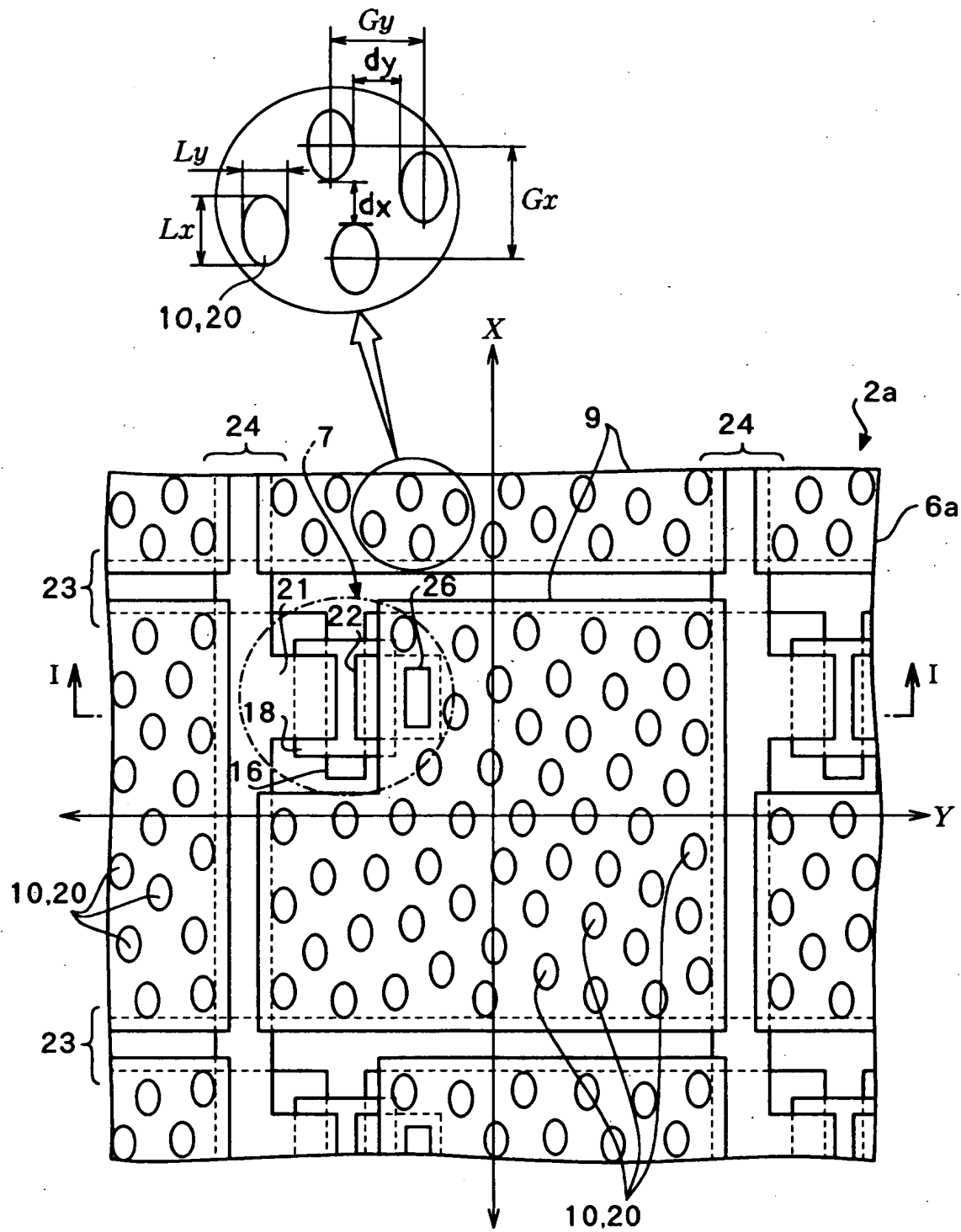
【図 2 1】



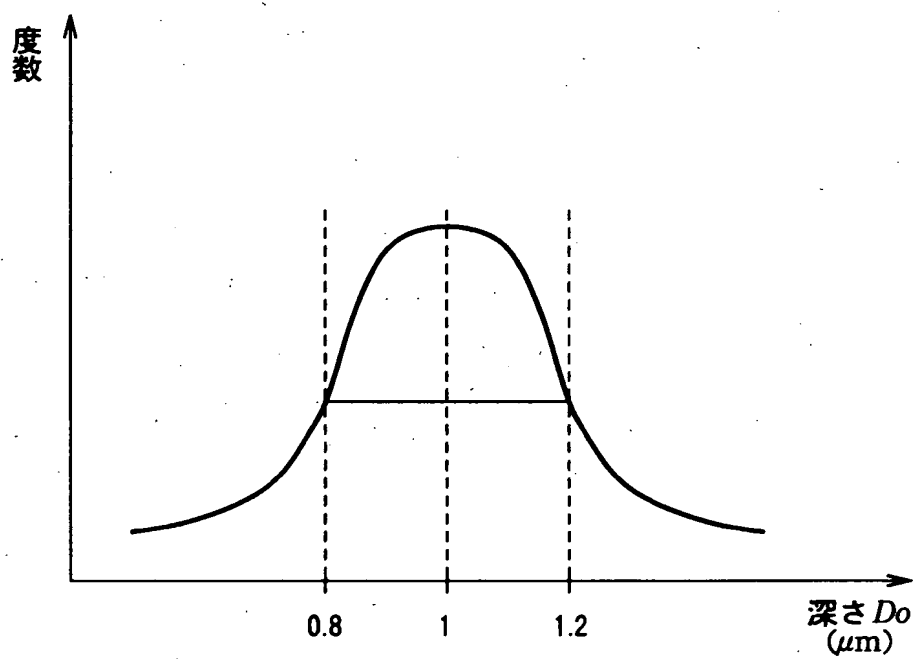
【図 22】



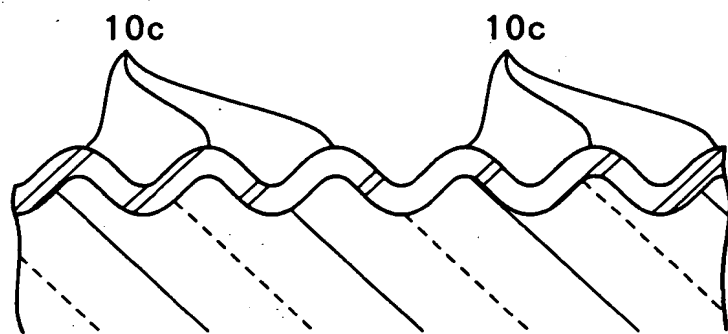
【図 23】



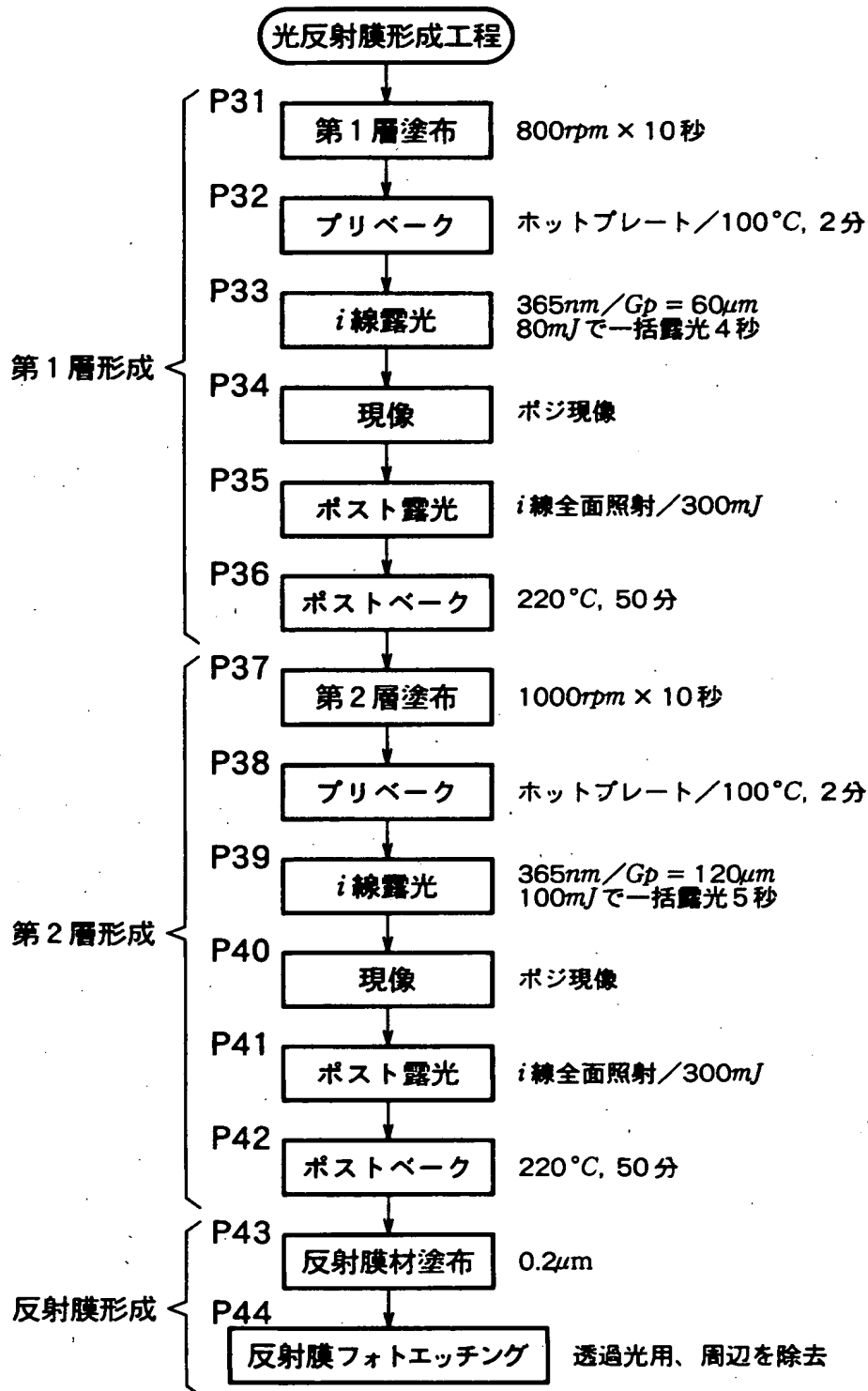
【図 24】



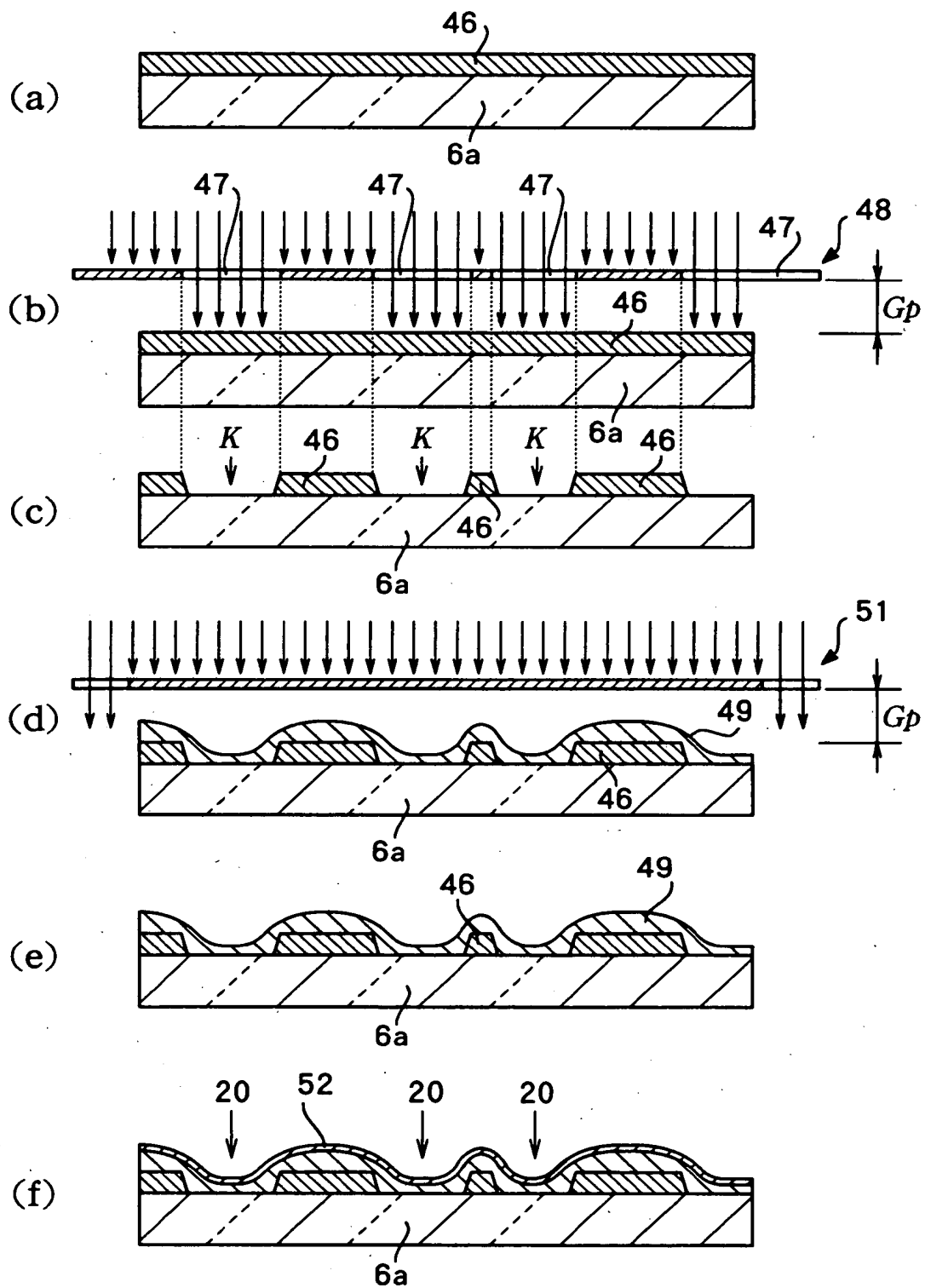
【図 2 5】



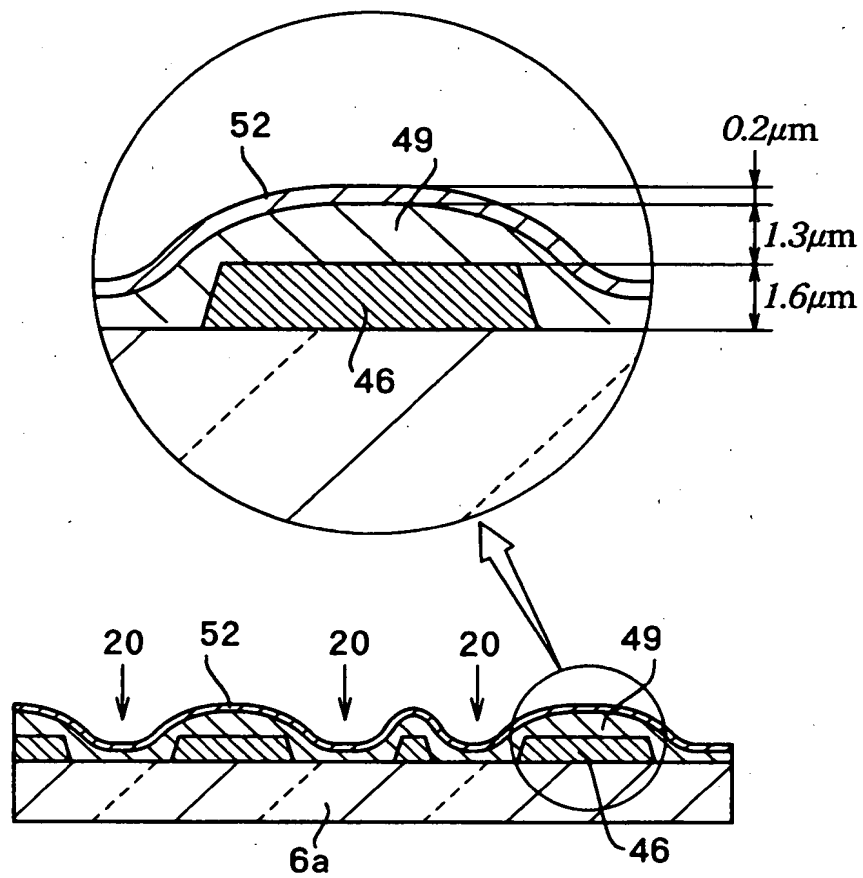
【図 26】



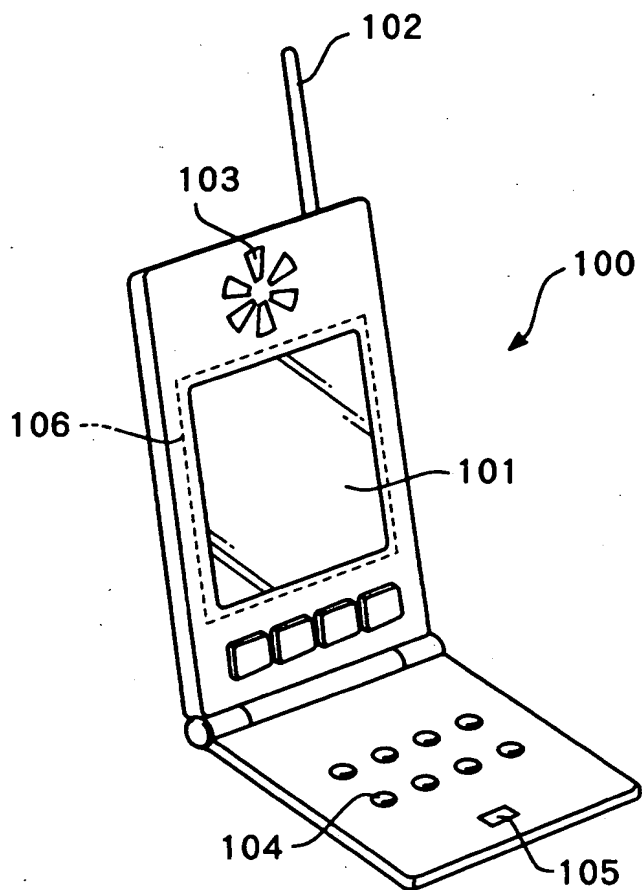
【図 27】



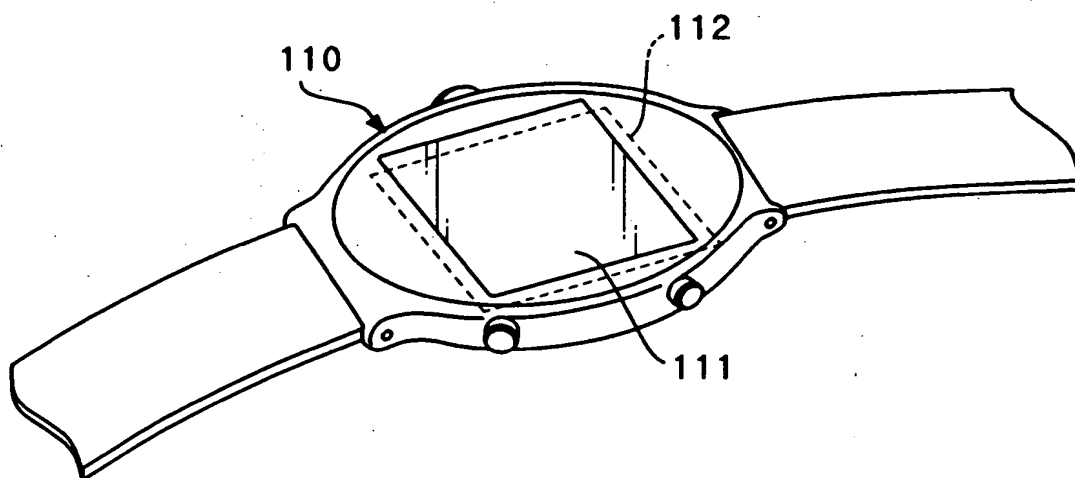
【図 28】



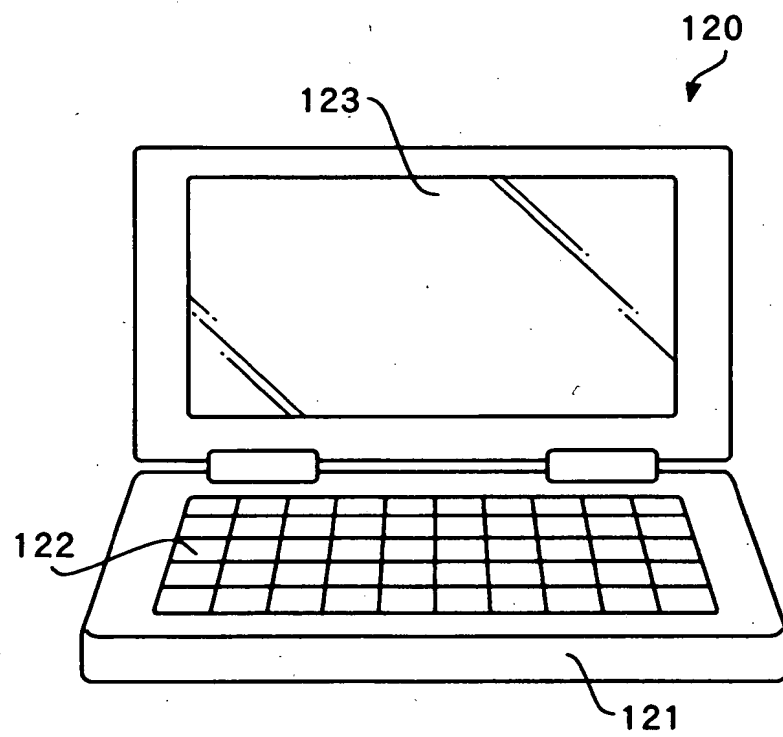
【図 29】



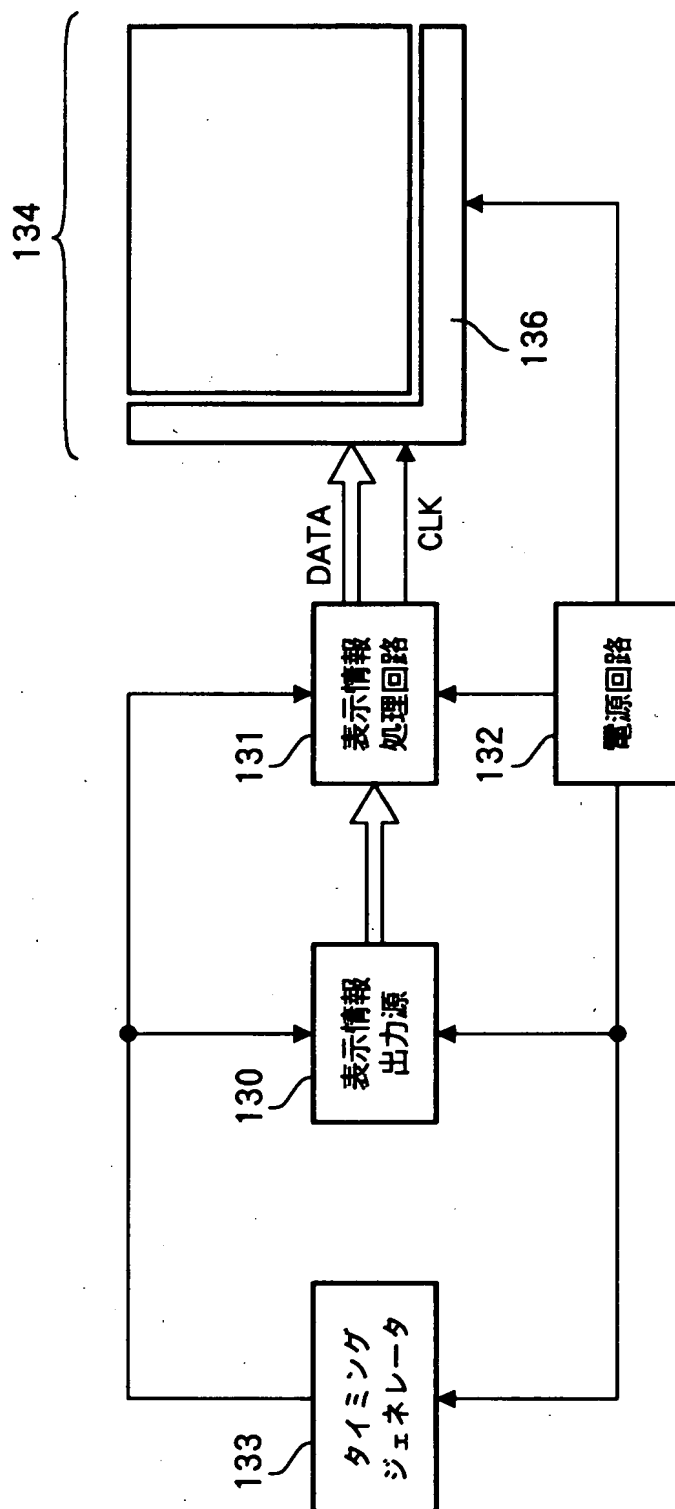
【図 30】



【図 3 1】



【図 3 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 反射光が不要な視野角方向へ進行することを防止して、希望する視野角方向へ向かう反射光の光量を増大させることにより、希望の方向から見たときの表示の明るさを増大させることのできる液晶装置用基板を提供する。

【解決手段】 液晶を挟持する一对の基板のうち観察側と反対側に位置する液晶装置用基板 2 a である。基材 6 a の表面に光反射膜としての画素電極 9 が形成される。光反射膜 9 の表面には複数の山部 1 0 c を並べて成るパターンが形成され、これらの山部 1 0 c は、自らを通る直交 2 軸線 X, Y の一方の軸線に沿った立体形状と、他方の軸線に沿った立体形状とが互いに異なるように、長円形状のドーム形状に形成される。光反射膜 9 は光指向性及び光散乱性の両方の特性を実現する。

【選択図】 図 2

認定・付加情報

| | |
|---------|-------------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2001-347606 |
| 受付番号 | 50101673454 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第二担当上席 0091 |
| 作成日 | 平成 13 年 11 月 16 日 |

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

| | |
|----------|------------------------|
| 【識別番号】 | 000002369 |
| 【住所又は居所】 | 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 |
| 【氏名又は名称】 | セイコーエプソン株式会社 |

【代理人】

申請人

| | |
|----------|--|
| 【識別番号】 | 100095728 |
| 【住所又は居所】 | 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社 知的財産部室内 |
| 【氏名又は名称】 | 上柳 雅誉 |

【選任した代理人】

| | |
|----------|---|
| 【識別番号】 | 100107076 |
| 【住所又は居所】 | 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社 知的財産室内 |
| 【氏名又は名称】 | 藤網 英吉 |

【選任した代理人】

| | |
|----------|--|
| 【識別番号】 | 100107261 |
| 【住所又は居所】 | 長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコーエプソン株式会社 知的財産部室内 |
| 【氏名又は名称】 | 須澤 修 |

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

| | |
|----------|------------------|
| 1. 変更年月日 | 1990年 8月20日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |
| 氏 名 | セイコーエプソン株式会社 |



A DOCPHOENIX

APPL PARTS



371P
PCT Papers in a 371 Application

A...
Amendment Including Elections

ABST
Abstract

ADS
Application Data Sheet

AF/D
Affidavit or Exhibit Received

APPENDIX
Appendix

ARTIFACT
Artifact

BIB
Bib Data Sheet

CLM
Claim

COMPUTER
Computer Program Listing

CRFL
All CRF Papers for Backfile

DIST
Terminal Disclaimer Filed

DRW
Drawings

FOR
Foreign Reference

FRPR
Foreign Priority Papers

IDS
IDS Including 1449

NPL
Non-Patent Literature

OATH
Oath or Declaration

PET.
Petition

RETMAIL
Mail Returned by USPS

SEQLIST
Sequence Listing

SPEC
Specification

SPEC NO
Specification Not in English

TRNA
Transmittal New Application

CTNF
Count Non-Final

CTRS
Count Restriction

EXIN
Examiner Interview

M903
DO/EO Acceptance

M905
DO/EO Missing Requirement

NFDR
Formal Drawing Required

NOA
Notice of Allowance

PETDEC
Petition Decision

OUTGOING



1449
Signed 1449

892
892

ABN
Abandonment

APDEC
Board of Appeals Decision

APEA
Examiner Answer

CTAV
Count Advisory Action

CTEQ
Count Ex parte Quayle

CTFR
Count Final Rejection

INCOMING

AP.B
Appeal Brief

C.AD
Change of Address

N/AP
Notice of Appeal

PA..
Change in Power of Attorney

REM
Applicant Remarks in Amendment

XT/
Extension of Time filed separate

Internal

SRNT
Examiner Search Notes

CLMPTO
PTO Prepared Complete Claim Set

ECBOX
Evidence Copy Box Identification

WCLM
Claim Worksheet

WFEE
Fee Worksheet

File Wrapper

FWCLM
File Wrapper Claim

IIFW
File Wrapper Issue Information

SRFW
File Wrapper Search Info

BACKFILE DOCUMENT INDEX SHEET

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

#4
6/84/02
amr



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年12月25日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-392828

出 願 人

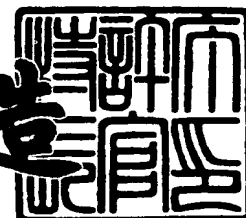
Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年11月30日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3105674